

上海古鳌电子科技股份有限公司拟了解
新存科技（武汉）有限责任公司
股东全部权益价值项目
估值咨询报告
沃克森咨报字(2026)第0216号
(共一册)

沃克森（北京）国际资产评估有限公司

二〇二六年四月十日

目 录

估值咨询报告声明.....	2
估值咨询报告·摘要.....	3
估值咨询报告·正文.....	4
一、 委托方、被估值咨询单位及其他估值咨询报告使用人.....	6
二、 估值目的.....	12
三、 估值对象和估值范围.....	12
四、 价值类型.....	32
五、 估值基准日.....	33
六、 估值依据.....	33
七、 估值方法.....	34
八、 估值程序实施过程和情况.....	37
九、 估值假设.....	39
十、 估值结论.....	41
十一、 特别事项说明.....	42
十二、 估值咨询报告使用限制说明.....	44
十三、 特别风险提示.....	45
十四、 估值咨询报告日.....	47

估值咨询报告声明

一、沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称：本估值机构）接受上海古鳌电子科技股份有限公司的委托，在新存科技（武汉）有限责任公司提供财务、运营、研发、商业规划及其他资料的基础上，按照通行的估值方法，对新存科技（武汉）有限责任公司的股东全部权益进行了估值。

二、委托方、被估值咨询单位应当对其提供资料的真实性、准确性、完整性、合法性负责。

三、本估值咨询报告属咨询性质，本估值咨询报告不是一份根据中国资产评估准则要求所撰写的报告，报告的观点仅基于财务分析，未将商业、法律、税务、监管环境等其他因素纳入考虑。

四、本估值咨询报告仅供委托方、估值委托合同中约定的其他估值咨询报告使用人和法律、行政法规规定的估值咨询报告使用人使用；除此之外，任何未经估值机构确认的机构或个人不能由于得到估值咨询报告而成为估值咨询报告使用者。

五、本报告仅为委托方了解新存科技（武汉）有限责任公司市场价值所需，本估值咨询报告不得用于股权交易、增资扩股、借款融资等任何投资、融资等经济行为。

六、本估值咨询报告中的分析、判断和结论受估值咨询报告中假设和限定条件的影响或限制，委托方或者估值委托合同约定的其他估值咨询报告使用人应当充分考虑估值咨询报告中载明的假设、限定条件及其对估值结论的影响。

七、本估值咨询报告是在新存公司按其商业计划书及管理层提供的盈利预测所述规划经营发展、IP授权到期后续转让如期实施、按商业计划书实现其产品后续迭代研发进度及技术性能、顺利融资以保持持续经营能力，不存在资金链断裂的情况、生产线如期筹建并按时投产、产品销售定价不存在较大偏差、产品良率实现预期水平的特定假设前提上得出的，提请报告使用者予以关注。

八、委托方或者估值委托合同约定的其他估值咨询报告使用人只能按照估值咨询报告载明的估值目的使用估值咨询报告，委托方或者估值委托合同约定的其他估值咨询报告使用人使用估值咨询报告，请务必阅读估值咨询报告全文并特别注意“特别风险提示及估值咨询报告使用限制”的影响。

上海古鳌电子科技股份有限公司拟了解 新存科技（武汉）有限责任公司 股东全部权益价值项目 估值咨询报告·摘要

沃克森咨报字(2026)第 0216 号

上海古鳌电子科技股份有限公司：

沃克森（北京）国际资产评估有限公司接受贵公司的委托，根据新存科技（武汉）有限责任公司提供的损益预测表、商业计划及现场访谈反馈等资料信息，按照必要的估值程序，对新存科技（武汉）有限责任公司于 2025 年 12 月 31 日的股东全部权益进行了估值咨询。现将估值咨询情况及估值咨询结果摘要报告如下：

一、估值咨询目的

根据估值咨询业务委托合同，上海古鳌电子科技股份有限公司拟了解新存科技（武汉）有限责任公司于估值咨询基准日的股东全部权益价值。

二、估值咨询对象与估值咨询范围

本次估值咨询对象为新存科技（武汉）有限责任公司的股东全部权益价值；估值咨询范围为经济行为之目的具体涉及的全部资产和负债。

新存科技（武汉）有限责任公司估值咨询基准日财务报表经过中汇会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所审计，出具中汇汉会审[2026]第 0012 号带有强调事项段的无保留意见的年度审计报告。

三、价值类型

市场价值。

四、估值咨询基准日

2025 年 12 月 31 日。

五、估值咨询方法

收益法。

六、估值咨询结论及其使用有效期

在经过实施必要的估值咨询程序，对新存科技（武汉）有限责任公司股东全部权益估值咨询结论如下：

截至估值咨询基准日 2025 年 12 月 31 日，新存科技（武汉）有限责任公司的股东全部权益价值为 181,062.16 万元。

估值咨询报论使用有效期为一年，自估值咨询基准日 2025 年 12 月 31 日起至 2026 年 12 月 30 日止。除本报告已披露的特别事项，在估值咨询基准日后、使用有效期以内，当经济行为发生时，如企业发展环境未发生影响其经营状况较大变化的情形，估值咨询结论在使用有效期内有效。

七、特别风险提示

鉴于被估值咨询单位新存科技（武汉）有限责任公司产品目前已研发公布了一代商用产品，其一代产品尚未实现量产，其 IP 授权到期后续转让实施、产品后续迭代研发进度及技术性能、生产线筹建投产、产品销售定价良率等方面存在重大不确定性，本报告仅为了解新存科技（武汉）有限责任公司特定假设前提下的股东全部权益市场价值所需，本估值咨询报告不得用于股权交易、增资扩股、借款融资等任何投资、融资等经济行为。

本估值咨询报告是在新存公司按其商业计划书及管理层提供的盈利预测所述规划经营发展、IP 授权到期后续转让如期实施、按商业计划书实现其产品后续迭代研发进度及技术性能、顺利融资以保持持续经营能力，不存在资金链断裂的情况、生产线如期筹建并按时投产、产品销售定价不存在较大偏差、产品良率如期实现预期水平的特定假设前提上得出的。提请报告使用者予以关注。

以上内容摘自估值咨询报告正文，欲了解本估值咨询业务的详细情况和正确理解估值咨询结论，应当阅读估值咨询报告正文。

上海古鳌电子科技股份有限公司拟了解 新存科技（武汉）有限责任公司 股东全部权益价值项目 估值咨询报告·正文

沃克森咨报字(2026)第 0216 号

上海古鳌电子科技股份有限公司：

沃克森（北京）国际资产评估有限公司接受贵公司的委托，根据新存科技（武汉）有限责任公司提供的损益预测表、商业计划及现场访谈反馈等资料信息，按照必要的估值咨询程序，对新存科技（武汉）有限责任公司于 2025 年 12 月 31 日的股东全部权益进行了估值咨询。现将估值咨询情况报告如下：

一、委托方、被估值咨询单位及其他估值咨询报告使用人

（一）委托方

企业名称：上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“上海古鳌”）

统一社会信用代码：91310000630452159C

注册地址：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号

法定代表人：徐迎辉

注册资金：34,006.2839 万人民币

成立日期：1996 年 7 月 8 日

经营范围：一般项目：货币专用设备制造；货币专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；安防设备制造；安防设备销售；机械设备研发；通用设备修理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；通讯设备销售；软件开发；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁，接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；软件外包服务；承接档案服务外包；信息技术咨询服务；数

据处理和存储支持服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数字广告制作；数字广告发布；数字广告设计、代理；数字内容制作服务(不含出版发行)，互联网数据服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口；技术进出口；金属门窗工程施工。计算机系统服务、云计算装备技术服务、云计算设备制造、云计算设备销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；大数据服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务；互联网设备销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；人民币鉴别仪产品生产；建筑智能化系统设计；电气安装服务；建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

（二）被估值咨询单位

1、公司介绍

企业名称：新存科技（武汉）有限责任公司（以下简称“新存公司”或“被估值咨询单位”）

统一社会信用代码：91420100MABTET690R

注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号武汉未来科技城龙山创意园一期 B4 栋 18 号楼 534（自贸区武汉片区）

法定代表人：鞠韶复

注册资金：1785.7540 万人民币

实收资本：1386.9918 万人民币

成立日期：2022 年 7 月 29 日

经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、组织结构



3、历史沿革

新存科技（武汉）有限责任公司是一家以存储芯片研发和销售为主的高科技企业，公司由我国存储领域唯一的国家级创新平台——国家先进存储产业创新中心孵化而来，核心成员均源自国家先进存储产业创新中心项目管理层。公司通过获得国家先进存储产业创新中心在三维相变存储器领域积累的全部技术及知识产权许可（已申请发明专利合计 273 件，国际专利 60 件，中国专利 213 件；已获授权中国专利 51 件；已获授权集成电路布图设计 11 个），并作为该技术的独占实施许可方。

新存科技（武汉）有限责任公司成立于 2022 年 7 月 29 日，初始注册资本 700 万元，公司现持有统一社会信用代码为 91420100MABTET690R 的营业执照，注册资本 1785.754 万人民币，营业期限为 2022 年 7 月 29 日至无固定期限。公司注册地为武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号武汉未来科技城龙山创新园一期 B4 栋 18 楼 534（自贸区武汉片区）。

截至估值咨询基准日，公司股权结构及注册资本实缴情况如下表：

单位：人民币万元

序号	股东名称	认缴金额	实缴金额	认缴比例
1	上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）	443.6383	443.6383	24.8432%
2	武汉市科铭芯企业管理合伙企业（有限合伙）	400.00	400.00	22.3995%
3	安吉高维安芯科技合伙企业（有限合伙）	300.00	300.00	16.7996%
4	刘峻	125.00	50.00	6.9999%
5	鞠韶复	125.00	50.00	6.9999%
6	武汉市科凌芯企业管理合伙企业（有限合伙）	50.00	0.00	2.7999%
7	上海科语宸企业管理合伙企业（有限合伙）	198.7622	0.00	11.1304%

上海古鳌电子科技股份有限公司拟了解
新存科技（武汉）有限责任公司股东全部权益价值项目估值咨询报告

项 目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
无形资产	63.64	92.63	49.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		665.22	327.81
递延所得税资产			
其他非流动资产	1,518.84		
资产总计	42,030.96	26,663.74	20,079.44
流动负债	13,190.79	30,089.98	55,050.56
非流动负债	14,015.14	10,348.35	1,094.08
负债合计	27,205.93	40,438.33	56,144.64
净资产（所有者权益）	14,825.01	-13,774.59	-36,065.21

损益状况如下表所示：

单位：人民币万元

项 目	2023 年度	2024 年度	2025 年度
一、营业收入	94.55	133.18	305.18
其中：主营业务收入	94.55	133.18	305.18
其他业务收入			
减：营业成本	94.55	133.18	536.42
其中：主营业务成本	94.55	133.18	536.42
其他业务成本			
税金及附加	21.53	18.72	12.70
销售费用	-	1.00	181.90
管理费用	2,298.27	4,589.58	4,529.28
研发费用	16,967.33	37,611.54	25,174.33
财务费用	475.45	742.15	510.42
资产减值损失	-		
信用减值损失	-5.73	-2.16	7.20
加：其他收益		20.84	356.63
投资收益		26.13	
净敞口套期收益			
公允价值变动收益			
资产处置收益			499.87
二、营业利润	-19,756.85	-42,913.86	-29,790.56
加：营业外收入			

项 目	2023 年度	2024 年度	2025 年度
其中：补贴收入			
减：营业外支出	0.06	0.40	9.88
三、利润总额	-19,756.91	-42,914.26	-29,800.44
减：所得税费用	2.00	5.37	
四、净利润	-19,758.91	-42,919.63	-29,800.44

注：以上 2023-2024 财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2025]第 ZE50159 号带有强调事项段的无保留意见年度审计报告；2025 年财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所审计，并出具中汇汉会审[2026]第 0012 号带有强调事项段的无保留意见年度审计报告。

5、主营业务及产品

新存公司主要业务领域是三维相变存储器。三维相变存储器是一种基于硫系化合物非晶和多晶之间的快速相变来实现信息存储的存储器。相变材料的物理状态可以通过加热或冷却来改变，从而实现信息的写入和读取。相比于传统的闪存存储器，三维相变存储器具有以下特点：

（1）高密度存储：三维相变存储器的特殊结构可以将存储单元缩小到几纳米，从而实现高密度存储。

（2）快速写入：三维相变存储器的写入速度可以达到几纳秒，比传统的闪存快得多，可以满足高速存储的需求。

（3）低功耗：由于其特殊的结构，功耗可以降低到几毫焦耳，比传统的闪存低得多，满足人们对低功耗存储的需求。

新存科技(武汉)有限责任公司于 2024 年 9 月 23 日发布了公司自主研发的国产首款最大容量新型三维存储器芯片——“NM101”。与市场上大容量非易失性产品相比，“NM101”芯片展现出了显著的优势。其单颗芯片容量高达 64Gb，最高速度可达 3200MT/s，支持随机读写，读写均可提速 10 倍以上，同时寿命增加了 5 倍。凭借这些卓越指标，系统解决方案的性能可以得到大幅提升，进而为虚拟化、数据库等应用领域的终端用户带来更加优质、高效的服务。

2025 年 1 月 22 日，新存公司发布了新一代非易失性新型存储器“NM102”。这款新产品不仅单颗芯片容量达到了 128Gb，更在性能上实现了重大突破，支持 4K

高速访问，读带宽高达 3.2GB/s，位宽 8bit，使用环境温度为 0~70 度。该芯片不仅在块存储等高性能场景能发挥巨大的性能优势，也可提供远超主流存储元件的允许数据写入量，是企业级用户降本增效的优秀选择。

以上两款产可用于企业级或消费级高性能存储产品。

（三）委托方与被估值咨询单位的关系

上海古鳌电子科技股份有限公司是上海昊元古信息管理合伙企业(有限合伙)的合伙人，持有上海昊元古信息管理合伙企业(有限合伙)93.0714%股权；上海昊元古信息管理合伙企业(有限合伙)是被估值咨询单位新存科技（武汉）有限责任公司的股东，持有新存公司 24.8432%股权。

（四）其他估值咨询报告使用人

根据估值咨询委托合同中约定的委托方为估值咨询报告使用人，无其他估值咨询报告使用人，任何未经估值咨询机构和委托方确认的机构或个人不能由于得到估值咨询报告而成为估值咨询报告使用人。

二、估值咨询目的

根据估值咨询业务委托合同，上海古鳌电子科技股份有限公司拟了解特定假设前提下新存科技（武汉）有限责任公司于估值咨询基准日的股东全部权益价值。

三、估值咨询对象和估值咨询范围

本次委托估值咨询对象和估值咨询范围与经济行为涉及的估值咨询对象和估值咨询范围一致。本次经济行为涉及的新存科技（武汉）有限责任公司的相关资料由委托方及被估值咨询单位提供。

（一）估值咨询对象

估值咨询对象为新存科技（武汉）有限责任公司的股东全部权益价值。

（二）估值咨询范围

估值咨询范围为经济行为之目的具体涉及的全部资产和负债。新存科技（武汉）有限责任公司估值咨询基准日财务报表经过中汇会计师事务所（特殊普通合

伙）武汉分所审计，出具中汇汉会审[2026]第 0012 号带有强调事项段的无保留意见年度报表审计报告。

截至估值咨询基准日新存公司经审计的合并资产负债情况如下：

单位：人民币万元

科 目	期末余额
货币资金	5,617.42
应收账款	282.80
预付账款	2.62
其他应收款	3.64
存货	-
其他流动资产	1,440.30
流动资产合计	7,346.78
长期应收款	627.97
长期股权投资	213.10
固定资产	1,444.54
在建工程	407.03
使用权资产	9,662.77
无形资产	49.43
长期待摊费用	327.81
非流动资产合计	12,732.65
资产总计	20,079.44
流动负债合计	55,050.56
非流动负债合计	1,094.08
负债合计	56,144.64
所有者权益	-36,065.21

注：以上财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所审计，并出具中汇汉会审[2026]第 0012 号带有强调事项段的无保留意见年度审计报告。

新存公司是从长江先进存储产业创新中心有限责任公司三维相变存储器项目技术团队孵化而来。2023 年 7 月长江先进存储产业创新中心有限责任公司通过了股东会会议文件议案 5《关于公司三维相变存储器项目产业化方案的议案》，议案商定现有员工根据自愿原则转入新存公司，并拟定将三维相变存储器项目研发初/中期阶段形成的技术及知识产权以可撤销的独占实施许可授权给新存公司。

北京中企华资产评估有限责任公司以 2023 年 2 月 28 日为评估基准日采用成本法对三维相变存储器项目涉及到的生产技术“Trident 项目”及其专有技术研发过程中形成的专利、集成电路布图设计进行了评估，并出具了《中企华评报字（2023）第 3457 号》评估结论为 123,973.50 万元的资产评估报告。

三维相变存储器项目由技术及知识产权授权单位长江先进存储产业创新中心有限责任公司于 2019 年 8 月开发立项，已成功开发出我国首款三维相变存储器测试芯片和原型芯片且完成芯片基本功能验证，并于 2022 年 7 月送样原型芯片首批 Working Sample。

根据 2023 年 7 月长江先进存储产业创新中心有限责任公司通过了股东会会议文件议案 5《关于公司三维相变存储器项目产业化方案的议案》，相关技术成果已达到产业化条件，目前处于产业化研发推进阶段。新存公司就此和长江先进存储产业创新中心有限责任公司于 2023 年 7 月 26 日签订了技术许可协议，许可年限为 5 年，协议约定许可费按照第一代产品销售收入的 1.5%、第二代产品销售收入的 1%收取，并约定最晚于许可协议结束后由新存公司购买相关无形资产并按照许可协议约定支付转让对价。

三维相变存储器具备低成本的价格优势，低延迟、高带宽、高速度的性能表现和非易失性的特性使其在服务器、数据中心、云存储方面有良好的市场前景。新存科技将持续推进与我国头部云服务厂商的技术合作，在现有的我国首款三维相变存储器原型芯片的基础上，加快研发出我国首款三维相变存储器产品芯片。新存科技(武汉)有限责任公司于 2024 年 9 月 23 日发布了公司自主研发的国产首款最大容量新型三维存储器芯片——“NM101”。其单颗芯片容量高达 64Gb，最高速度可达 3200MT/s，支持随机读写，读写均可提速 10 倍以上，同时寿命增加了 5 倍。2025 年 1 月 22 日，新存公司发布了新一代非易失性新型存储器“NM102”。这款新产品单颗芯片容量达到了 128Gb，在性能支持 4K 高速访问，读带宽高达 3.2GB/s，位宽 8bit，使用环境温度为 0~70 度。该芯片目前已完成技术验证，并可以正式商用。

（三）主要资产配置、概况和权属情况

实物资产为机器设备和电子设备。上述实物资产主要分布新存公司及其下属公司的办公场所内。具体实物资产类型及特点如下：

机器设备 14 台，主要为爱德万 T5835 测试机和 DTH E3 tester 设备。经与被工作单位了解，截至估值咨询基准日，纳入估值咨询范围的机器设备维护、保养、使用正常。

电子设备共计 300 项，主要为笔记本电脑、台式电脑、打印机、考勤机、音响等。

截至估值咨询基准日，纳入估值咨询范围的电子设备维护、保养、使用正常。

（四）经营租入资产情况

本次估值咨询范围存在经营租入资产和账外无形资产。

1、截至估值咨询基准日，被估值咨询单位存在以下租赁事项：

序号	租赁物	承租人	出租人	位置	租赁物 m ²	年租金 (元)	租赁期限
1	北京办公室	新存科技（武汉）有限责任公司	长江存储科技有限责任公司	/	/	2,703,811.30	2024/8/1 至 2028/8/31
2	创新中心设备租赁	新存科技（武汉）有限责任公司	长江先进存储产业创新中心有限责任公司	/	/	45,254,173.20	2024/6/1 至 2028/5/31
3	光谷未来馆 05 层 CFB-5-01 号 场地	新存科技（武汉）有限责任公司	武汉长江存储科技服务有限公司	湖北省武汉市东湖新技术开发区未来三路 88 号国家存储器基地项目一期未来馆	1323	第一年： 1,603,476.00 第二年： 1,635,228.00 第三年： 1,666,980.00 第四年： 1,714,608.00	2024/11/1 至 2028/10/31
		新存科技（武汉）有限责任公司	武汉长江存储科技服务有限公司		171	59,508.00	2023/11/1 至 2028/10/31

上海古鳌电子科技股份有限公司拟了解
新存科技（武汉）有限责任公司股东全部权益价值项目估值咨询报告

			公司				
4	长存设备	新存科技（武汉）有限责任公司	武汉长江存储科技服务有限公司	/	/	33,321,559.42	2025/1/1 至 2025/12/31
5	未来馆二期	新存科技（武汉）有限责任公司	武汉长江存储科技服务有限公司	湖北省武汉市东湖新技术开发区未来三路88号国家存储器基地项目一期未来馆		第一年： 992,880.00 第二年： 1,022,666.40 第三年： 1,053,303.84 第四年： 1,084,934.16 第五年： 1,117,415.52	2024/5/15 至 2028/5/15
6	长存设备（新）	新存科技（武汉）有限责任公司	长江存储科技有限责任公司	/	/	33,321,559.42	2026/1/1 至 2027/12/31
7	长存 Chamber 租赁	新存科技（武汉）有限责任公司	长江存储科技有限责任公司	/	/	3,272,419.56	2024/7/1 至 2025/12/31
8	长存 Chamber 租赁	新存科技（武汉）有限责任公司	长江存储科技有限责任公司	/	/	29,488,105.68	2026/1/1 至 2027/12/31

（五）企业申报的可辨认无形资产类型、数量、法律权属状况

账面记录的无形资产系办公用软件及域名，共计 4 项，具体如下：

单位：人民币元

序号	名称	取得日期	原始入账价值	账面价值
1	numrmory.com 域名购买费用	2023/9/13	22,560.00	5,013.30
2	新存 M365 邮件系统	2023/10/31	672,343.30	168,085.80
3	泛微 OA	2024/7/31	232,686.60	116,343.30
4	金蝶 ERP+HR 软件	2024/9/30	368,655.87	204,808.80

（六）企业申报表外资产的类型、数量

新存科技(武汉)有限责任公司申报表外资产系三维相变存储器方面与 CMOS

器件结构和工艺、BEOL（包括引线相关的结构和工艺、半导体工艺、方法和制程）相关的技术及知识产权分为授权部分、自有部分。具体情况如下：

(1) 授权部分

根据长江先进存储产业创新中心有限责任公司与新存科技（武汉）有限责任公司签订的《技术及知识产权许可合同》，新存公司以免许可费的、全球范围内的、永久的、可撤销的、非排他许可且分许可仅为其定制化代工方的方式取得三维相变存储器方面与 CMOS 器件结构和工艺、BEOL（包括引线相关的结构和工艺、半导体工艺、方法和制程）相关的技术及知识产权，许可期限自 2023 年 7 月 26 日起。

该合同涉及具体知识产权清单情况如下：

a) 涉及专利

序号	发明名称	申请号	申请日	法律状态	申请人
1	Novel distributed array and CMOS architecture for 2 stack 3D phase change memory with higher array efficiency	PCT/CN2020/089718	2020/5/12	PCT 进入指定国（指定期满）	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
2	A novel distributed array and contact architecture for 4 stack 3D PCM memory	PCT/CN2020/089719	2020/5/12	PCT 进入指定国（指定期满）	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
3	An array and CMOS architecture for 3D phase change memory with higher array efficiency	PCT/CN2020/094346	2020/6/4	PCT 进入指定国（指定期满）	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
4	New cell structure with reduced programming current and thermal cross talk for 3D x-point memory	PCT/CN2020/104909	2020/7/27	PCT 进入指定国（指定期满）	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
5	Novel program and read biasing scheme for distributed array and CMOS architecture for 4 stack 3D PCM memory	PCT/CN2020/106377	2020/7/31	PCT 进入指定国（指定期满）	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
6	Novel array and contact architecture for 4 stack 3D crosspoint memory	PCT/CN2020/108615	2020/8/12	PCT 进入指定国（指定期满）	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
7	Novel integration scheme to form vertical 3D x-point memory with lower cost	PCT/CN2020/108782	2020/8/13	PCT 进入指定国（指定期满）	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
8	New cell stack with reduced WL and bl resistance for 3D x-point memory to improve program and increase array size	PCT/CN2020/108487	2020/8/11	PCT 进入指定国（指定期满）	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
9	A new replacement bit line and word line scheme for 3D phase change memory to improve program and increase array size	PCT/CN2020/108486	2020/8/11	PCT 进入指定国（指定期满）	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
10	Program and read biasing scheme for distributed array and CMOS architecture for 2 stack 3D PCM memory	PCT/CN2020/109916	2020/8/19	PCT 进入指定国（指定期满）	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
11	New array layout and program scheme for 3D crosspoint memory to lower latency and increase array size	PCT/CN2020/109723	2020/8/18	PCT 进入指定国（指定期满）	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
12	Novel distributed array and contact architecture for 4 stack 3D x-point memory	PCT/CN2020/113459	2020/9/4	PCT 进入指定国（指定期满）	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
13	Phase-change memory devices having metal filament threshold switching selector and methods for forming the same	PCT/CN2020/115786	2020/9/17	PCT 进入指定国（指定期满）	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
14	Method to use laminate gap fill to reduce thermal cross talk in 3D x-point memory array	PCT/CN2020/120144	2020/10/10	PCT 进入指定国（指定期满）	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
15	Method to reduce thermal cross talk in 3D x-point memory array	PCT/CN2020/120145	2020/10/10	PCT 进入指定国（指定期满）	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
16	A new constriction cell structure and fabrication method with reduced programming current and thermal cross talk for 3D x-point memory	PCT/CN2020/120459	2020/10/12	PCT 进入指定国（指定期满）	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
17	Novel self-aligned half damascene contact scheme to reduce cost for 3D PCM	PCT/CN2020/120435	2020/10/12	PCT 进入指定国（指定期满）	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
18	Novel integration scheme with CPU bonding to 3D xpoint chip	PCT/CN2020/120321	2020/10/12	PCT 进入指定国（指定期满）	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
19	Multiple integration scheme with ASIC or FPGA chip bonding to 3D crosspoint chip	PCT/CN2020/120322	2020/10/12	PCT 进入指定国（指定期满）	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
20	Array and contact architecture for four stack three dimensional cross point memory	PCT/CN2020/121071	2020/10/15	PCT 进入指定国（指定期满）	长江先进存储产业创新中心有限责任公司

上海古鳌电子科技股份有限公司拟了解
新存科技（武汉）有限责任公司股东全部权益价值项目估值咨询报告

序号	发明名称	申请号	申请日	法律状态	申请人
21	3D cross point memory structure formed by xtacking to improve memory array efficiency and enable scaling	PCT/CN2020/120585	2020/10/13	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
22	Architecture, method and memory cell for 3D NAND style mfmis fefet to enable 3D ferroelectric nonvolatile data storage	PCT/CN2020/123204	2020/10/23	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
23	ARCITECTURE, STRUCTURE, METHOD AND MEMORY ARRAY FOR 3D FeFET TO ENABLE 3D FERROELETRIC NONVOLATILE DATA STORAGE	PCT/CN2020/123293	2020/10/23	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
24	ARCITECTURE, STRUCTURE, METHOD AND MEMORY ARRAY FOR 3D FeRAM	PCT/CN2020/123331	2020/10/23	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
25	A program and read bias and access scheme to improve data throughput for 2 stack 3D PCM memory	PCT/CN2020/123258	2020/10/23	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
26	Memory devices having memory cells with multiple threshold voltages and methods for forming and operating the same	PCT/CN2020/127420	2020/11/9	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
27	A novel gap fill and cell structure for improved selector thermal reliability for 3D PCM	PCT/CN2020/129307	2020/11/17	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
28	Novel segmented word line and bit line scheme for 3D PCM to improve line integrity and prevent line toppling	PCT/CN2020/129606	2020/11/18	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
29	Vertical 3D PCM memory cell and program read scheme	PCT/CN2020/129760	2020/11/18	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
30	New bitline architecture and method to improve page size and performance of 3dnand	PCT/CN2020/131114	2020/11/24	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
31	New super-lattice cell structure and fabrication method with reduced programming current and thermal cross talk for 3D x-point memory	PCT/CN2020/131085	2020/11/24	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
32	Novel recess liner confined cell structure and fabrication method with reduced programming current and thermal cross talk for 3D x-point memory	PCT/CN2020/133050	2020/12/1	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
33	A novel liner confined cell structure and fabrication method with reduced programming current and thermal cross talk for 3D x-point memory	PCT/CN2020/133051	2020/12/1	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
34	New liner electrode cell structure and fabrication method with reduced programming current and thermal cross talk for 3D x-point memory	PCT/CN2020/133052	2020/12/1	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
35	Phase-change memory cell structure and method for fabricating the same	PCT/CN2021/071821	2021/1/14	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
36	Phase-change memory cell and method for fabricating the same	PCT/CN2021/071817	2021/1/14	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
37	Three-dimensional phase-change memory devices and methods for forming thereof	PCT/CN2021/094294	2021/5/18	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
38	Three-dimensional phase-change memory devices and methods for forming the same	PCT/CN2021/094295	2021/5/18	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
39	Three-dimensional phase-change memory devices and forming method thereof	PCT/CN2021/094492	2021/5/19	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
40	Memory device and controlling method thereof	PCT/CN2021/095105	2021/5/21	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
41	Phase-change memory devices with selector having defect reduction material and methods for forming the same	PCT/CN2021/108803	2021/7/28	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
42	Phase-change memory device and method for forming the same	PCT/CN2021/108810	2021/7/28	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
43	Memory device and controlling method thereof	PCT/CN2021/113418	2021/8/19	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
44	Memory device and controlling method thereof	PCT/CN2021/113403	2021/8/19	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
45	Phase-change memory device and operation method thereof	PCT/CN2021/125507	2021/10/22	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
46	Phase-change memory device and method for forming the same	PCT/CN2021/130837	2021/11/16	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
47	Memory device and layout of the same	PCT/CN2021/137804	2021/12/14	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
48	Three-dimensional memory device and method of manufacturing thereof	PCT/CN2022/080348	2022/3/11	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
49	Memory peripheral circuit having recessed channel transistors and method for forming the same	PCT/CN2022/091080	2022/5/6	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
50	Memory peripheral circuit having recessed channel transistors with elevated sources/drains and method for forming thereof	PCT/CN2022/091082	2022/5/6	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
51	Memory system, memory device, and method for read reference voltage management	PCT/CN2022/093753	2022/5/19	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
52	Memory device and controlling method thereof	PCT/CN2022/120182	2022/9/21	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
53	Integrated circuit device, packaging, and method for forming thereof	PCT/CN2022/120181	2022/9/21	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司

上海古鳌电子科技股份有限公司拟了解
新存科技（武汉）有限责任公司股东全部权益价值项目估值咨询报告

序号	发明名称	申请号	申请日	法律状态	申请人
54	Microelectromechanical system pressure sensor with pressure sensing element having phase-change material	PCT/CN2022/128013	2022/10/27	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
55	Memory device and addressing method thereof	PCT/CN2022/128149	2022/10/28	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
56	Memory device and addressing method thereof	PCT/CN2022/128145	2022/10/28	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
57	Memory device and operating method thereof	PCT/CN2022/128140	2022/10/28	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
58	Three-dimensional phase-change memory and methods for making same	PCT/CN2022/131450	2022/11/11	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
59	A multi-stack three-dimensional phase-change memory and methods for making the same	PCT/CN2022/131316	2022/11/11	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
60	Three-dimensional phase-change memory and methods	PCT/CN2022/131346	2022/11/11	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
61	Three-dimensional phase-change memory devices and controlling method thereof	PCT/CN2023/088667	2023/4/17	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
62	Three-dimensional phase-change memory devices and controlling method thereof	PCT/CN2023/088672	2023/4/17	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
63	用于具有更高阵列效率的 2 堆叠 3D 相变存储器的新型分布式阵列和 CMOS 架构	CN202080001051.X	2020/5/12	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
64	用于 4 堆叠 3D PCM 存储器的新型分布式阵列和触点架构	CN202080001056.2	2020/5/12	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
65	用于具有更高阵列效率的 3D 相变存储器的阵列和 CMOS 架构	CN202080001271.2	2020/6/4	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
66	用于 3D X-Point 存储器的具有减小的编程电流和热串扰的新单元结构	CN202080001721.8	2020/7/27	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
67	针对用于 4 堆叠 3D PCM 存储器的分布式阵列和 CMOS 架构的新颖的编程和读取偏置方案	CN202080001883.1	2020/7/31	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
68	用于 4 堆叠 3D 交叉点型存储器的新颖的阵列和触点架构	CN202080002045.6	2020/8/12	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
69	用于以较低成本形成垂直 3D X-POINT 存储器的新颖集成方案	CN202080001881.2	2020/8/13	授权 复审	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
70	2 叠层 3D PCM 存储器的分布式阵列和 CMOS 架构的编程和读取偏置方案	CN202080002072.3	2020/8/19	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
71	用于 3D 交叉点存储器降低时延并增加阵列大小的新阵列布局和编程方案	CN202080001995.7	2020/8/18	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
72	用于 4 堆叠 3D X 点存储器的新型分布式阵列和触点架构	CN202080002267.8	2020/9/4	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
73	具有金属丝阈值切换选择器的相变存储器件及其形成方法	CN202080002423.0	2020/9/17	实质审查 复审	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
74	用于使用层间间隙填充来减少 3D 交叉点存储器阵列中的热串扰的方法	CN202080002919.8	2020/10/10	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
75	用于减小 3D 交叉点存储器阵列中的热串扰的方法	CN202080002909.4	2020/10/10	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
76	用于 3D 交叉点存储器的具有减小的编程电流和热串扰的缩小单元结构和制造方法	CN202080002916.4	2020/10/12	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
77	采用 CPU 向 3D XPOINT 芯片键合的新颖集成方案	CN202080002712.0	2020/10/12	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
78	采用向 3D 交叉点芯片键合 ASIC 或 FPGA 芯片的多重集成方案	CN202080002721.X	2020/10/12	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
79	用于四个堆叠层三维交叉点存储器的阵列和接触架构	CN202080002803.4	2020/10/15	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
80	用于四个堆叠层三维交叉点存储器的阵列和接触架构	CN202111270369.0	2020/10/15	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
81	通过 XTACKING 形成的用以提高存储器阵列效率并且实现缩放的新型 3D 交叉点存储器结构	CN202080002658.X	2020/10/13	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
82	用于 3D NAND 类型 MFMS FeFET 以实现 3D 铁电非易失性数据存储的架构、方法和存储器单元	CN202080002937.6	2020/10/23	实质审查	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
83	用于实现 3D 铁电非易失性数据存储的 3D FeFET 的架构、结构、方法和存储阵列	CN202080003073.X	2020/10/23	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
84	用于 3D FeRAM 的架构、结构、方法和存储阵列	CN202080003086.7	2020/10/23	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
85	用以提高 2 堆叠体 3D PCM 存储器的数据吞吐量的编程和读取偏置和访问方案	CN202080003147.X	2020/10/23	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
86	具有多个阈值电压的存储单元的存储器件及其形成和操作方法	CN202080003338.6	2020/11/9	实质审查 复审	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
87	用于 3D PCM 的改进的选择器热可靠性的新颖间隙填充和单元结构	CN202080003517.X	2020/11/17	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司

上海古鳌电子科技股份有限公司拟了解
新存科技（武汉）有限责任公司股东全部权益价值项目估值咨询报告

序号	发明名称	申请号	申请日	法律状态	申请人
88	垂直 3D PCM 存储单元和编程读取方案	CN202080003468.X	2020/11/18	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
89	一种三维交叉点存储单元结构和制造方法	CN202080003785.1	2020/11/24	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
90	用于 3D X 点存储器的凹陷衬垫限制单元结构和制造方法	CN202080004159.4	2020/12/1	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
91	具有衬垫限制单元结构的三维存储器及其制造方法	CN202080004158.X	2020/12/1	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
92	用于 3D X 点存储器的具有减小的编程电流和热串扰的衬垫电极单元结构和制造方法	CN202080004155.6	2020/12/1	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
93	相变存储器单元结构及其制造方法	CN202180000265.X	2021/1/14	授权 复审	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
94	三维相变存储器器件及其形成方法	CN202180001535.9	2021/5/18	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
95	三维相变存储器器件及其形成方法	CN202180001588.0	2021/5/19	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
96	存储设备及其控制方法	CN202180001798.X	2021/5/21	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
97	具有包含缺陷减少材料的选择器的相变存储器装置及其形成方法	CN202180002426.9	2021/7/28	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
98	相变存储器器件及其形成方法	CN202180002427.3	2021/7/28	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
99	存储器器件及其控制方法	CN202180002725.2	2021/8/19	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
100	存储器装置及其控制方法	CN202180003084.2	2021/8/19	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
101	相变存储器器件及其操作方法	CN202180003829.5	2021/10/22	实质审查	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
102	相变存储器设备及其形成方法	CN202180004640.8	2021/11/16	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
103	存储器器件及其布局	CN202180004837.1	2021/12/14	实质审查	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
104	三维存储装置及其制造方法	CN202280001144.1	2022/3/11	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
105	具有凹槽式沟道晶体管的存储器外围电路及其形成方法	CN202280001929.9	2022/5/6	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
106	具有带有升高源极/漏极的凹槽式沟道晶体管的存储器外围电路及其形成方法	CN202280001934.X	2022/5/6	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
107	带有含相变材料的压力传感元件的机电系统压力传感器	CN202280004781.4	2022/10/27	实质审查	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
108	存储器设备及其寻址方法	CN202280005055.4	2022/10/28	实质审查	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
109	三维相变存储器及其制作方法	CN202280005288.4	2022/11/11	实质审查	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
110	多堆叠体三维相变存储器及其制作方法	CN202280005558.1	2022/11/11	实质审查	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
111	三维相变存储器及其制造方法	CN202280005448.5	2022/11/11	实质审查	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
112	三维相变存储器及其制造方法	CN202111252492.X	2021/10/27	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
113	相变存储器及其制造方法	CN202111323680.7	2021/11/8	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
114	相变存储器及其制备方法	CN202111362769.4	2021/11/17	实质审查	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
115	相变存储器及其制作方法	CN202111328779.6	2021/11/10	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
116	相变存储器及其制造方法	CN202111386891.5	2021/11/22	实质审查	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
117	化学机械研磨装置	CN202122471775.5	2021/10/13	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
118	相变存储器及其制造方法	CN202111154527.6	2021/9/29	实质审查	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
119	相变存储单元的测试结构	CN202122605648.X	2021/10/27	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
120	套刻量测方法、半导体器件的制作方法	CN202111257832.8	2021/10/27	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
121	相变存储器的封装结构	CN202111574842.4	2021/12/21	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司

上海古鳌电子科技股份有限公司拟了解
新存科技（武汉）有限责任公司股东全部权益价值项目估值咨询报告

序号	发明名称	申请号	申请日	法律状态	申请人
122	存储器及其控制系统	CN202111192916.8	2021/10/13	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
123	相变存储器单元的操作方法及系统、计算机可读存储介质	CN202111138338.X	2021/9/27	实质审查	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
124	金属导电结构的制造方法	CN202110978330.8	2021/8/23	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
125	存储器芯片及其制造方法、指定存储单元的定位方法	CN202111138317.8	2021/9/27	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
126	相变存储器及其制造方法	CN202110904033.9	2021/8/6	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
127	相变薄膜、相变存储器及相变存储器的操作方法	CN202110851385.2	2021/7/27	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
128	用于双重成像工艺的套刻精度的检测结构及其检测方法	CN202111124092.0	2021/9/24	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
129	短路缺陷的检测结构及用于存储器的检测系统	CN202122131132.6	2021/9/3	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
130	相变存储器及其控制电路	CN202110728998.7	2021/6/29	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
131	相变存储器及其制备方法	CN202110591332.1	2021/5/28	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
132	存储器的控制系统及其控制方法	CN202110559873.6	2021/5/21	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
133	具有去耦电容的集成电路芯片及其制造方法	CN202110305307.2	2021/3/18	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
134	三维存储器及其制作方法	CN202110443742.1	2021/4/23	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
135	三维存储器件	CN202110059873.X	2021/1/18	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
136	半导体器件及其制备方法	CN202110492158.5	2021/5/6	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
137	一种半导体器件及其制备方法	CN202011451914.1	2020/12/10	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
138	一种半导体器件及其制备方法	CN202011474868.7	2020/12/14	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
139	半导体结构的制作方法	CN202011544162.3	2020/12/24	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
140	相变存储装置及其制作方法	CN202110063237.4	2021/1/18	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
141	半导体器件及其制备方法	CN202110492148.1	2021/5/6	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
142	半导体器件及其制备方法	CN202110492159.X	2021/5/6	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
143	半导体器件及其制备方法	CN202110492156.6	2021/5/6	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
144	一种确定用于对存储器执行操作的参考电压的方法	CN202110108528.0	2021/1/27	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
145	三维相变存储器的制备方法及三维相变存储器	CN202010814167.7	2020/8/13	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
146	一种相变存储器及其制造方法	CN202010980851.2	2020/9/17	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
147	具有四层堆叠的三维存储器	CN202011099506.4	2020/10/14	实质审查	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
148	存储器及其制作方法	CN202011244805.2	2020/11/10	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
149	中央处理器的制造方法、中央处理器及其控制方法	CN202110124866.3	2021/1/29	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
150	一种存储器及其制备方法	CN202010924270.7	2020/9/4	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
151	三维存储器	CN202011094046.6	2020/10/14	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
152	矩阵与向量的乘法运算方法及装置	CN202011492832.1	2020/12/17	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
153	一种三维相变存储器及其控制方法	CN202011258822.1	2020/11/12	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
154	三维存储器的控制方法、装置及存储介质	CN202011200027.7	2020/11/2	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
155	相变存储器及相变存储器的制作方法	CN202010879952.0	2020/8/27	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司

上海古鳌电子科技股份有限公司拟了解
新存科技（武汉）有限责任公司股东全部权益价值项目估值咨询报告

序号	发明名称	申请号	申请日	法律状态	申请人
156	一种三维相变存储器及其控制方法	CN202011259559.8	2020/11/12	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
157	三维存储器的制造方法	CN202011105053.1	2020/10/15	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
158	一种半导体器件的形成方法及半导体器件	CN202011296157.5	2020/11/18	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
159	相变存储器以及相变存储器的制造方法	CN202011444850.2	2020/12/11	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
160	一种半导体器件的形成方法及半导体器件	CN202011360297.4	2020/11/27	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
161	一种三维存储器的形成方法及三维存储器	CN202011349870.1	2020/11/26	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
162	相变存储器及相变存储器的制作方法	CN202011159709.8	2020/10/27	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
163	一种三维相变存储器及其制备方法	CN202011114967.4	2020/10/19	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
164	三维相变存储器及其制备方法	CN202011296156.0	2020/11/18	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
165	相变存储器及其制造方法、读取方法	CN202011436707.9	2020/12/11	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
166	半导体结构及其制造方法	CN202011322775.2	2020/11/23	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
167	相变存储器的制造方法及相变存储器	CN202011497011.7	2020/12/17	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
168	相变存储器的制造方法	CN202011501781.4	2020/12/17	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
169	相变存储器及相变存储器的制作方法	CN202011160307.X	2020/10/27	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
170	一种三维相变存储器的形成方法及三维相变存储器	CN202110263417.7	2021/3/11	授权 复审	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
171	相变存储器及其制造方法	CN202011482008.8	2020/12/15	实质审查 复审	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
172	沉积装置及方法	CN202011479958.5	2020/12/15	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
173	一种相变存储器及其制作方法	CN202011479690.5	2020/12/15	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
174	中央处理器及其制造方法	CN202110126171.9	2021/1/29	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
175	中央处理器及其制造方法	CN202110256421.0	2021/3/9	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
176	相变存储器及其制作方法	CN202110155225.4	2021/2/4	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
177	相变存储器及其制作方法	CN202110765768.8	2021/7/7	实质审查	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
178	三维相变存储器及其制备方法	CN202110198002.6	2021/2/22	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
179	相变存储器及其制作方法	CN202110166326.1	2021/2/4	授权 复审	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
180	三维相变存储器及其制备方法	CN202110198006.4	2021/2/22	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
181	三维存储器	CN202110401594.7	2021/4/14	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
182	一种三维相变存储器及其制备方法	CN202110202718.9	2021/2/23	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
183	一种半导体器件及其制造方法	CN202110360005.5	2021/4/2	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
184	一种冗余填充方法	CN202110359995.0	2021/4/2	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
185	相变存储器及其制备方法	CN202110198358.X	2021/2/22	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
186	一种三维存储器及三维存储器的形成方法	CN202110185001.8	2021/2/10	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
187	一种三维存储器及散热管道的形成方法	CN202110266545.7	2021/3/11	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
188	一种半导体芯片的形成方法及半导体芯片	CN202110267960.4	2021/3/11	实质审查	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
189	一种半导体器件的形成方法及半导体器件	CN202110266325.4	2021/3/11	实质审查	长江先进存储产业创新中心有限责任公司

上海古鳌电子科技股份有限公司拟了解
新存科技（武汉）有限责任公司股东全部权益价值项目估值咨询报告

序号	发明名称	申请号	申请日	法律状态	申请人
190	相变存储器及其制作方法	CN202110155493.6	2021/2/4	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
191	相变存储器及其制作方法	CN202110765596.4	2021/7/7	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
192	三维相变存储器及其制备方法	CN202110198695.9	2021/2/22	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
193	相变存储器及其制作方法	CN202110350652.8	2021/3/31	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
194	一种三维相变存储器及其控制方法	CN202110497138.7	2021/5/7	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
195	相变存储器及其制作方法	CN202110768188.4	2021/7/7	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
196	中央处理器及其制造方法	CN202110257283.8	2021/3/9	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
197	三维存储器及其制作方法	CN202110402587.9	2021/4/14	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
198	相变存储器的控制方法、装置及存储介质	CN202110358178.3	2021/4/1	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
199	一种三维相变存储器的制备方法及三维相变存储器	CN202110390849.4	2021/4/12	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
200	一种硬掩膜叠层结构及半导体器件的形成方法	CN202110440990.0	2021/4/23	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
201	三维存储器及其制作方法	CN202110402635.4	2021/4/14	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
202	相变存储器的制备方法、制备的控制方法以及相变存储器	CN202110405089.X	2021/4/15	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
203	一种三维相变存储器及其制备方法	CN202110334457.6	2021/3/29	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
204	一种三维相变存储器及其制备方法	CN202110611029.3	2021/6/1	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
205	一种相变存储器系统及其访问方法	CN202111230792.8	2021/10/22	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
206	三维存储器及其制造方法	CN202110454675.3	2021/4/26	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
207	一种硬掩膜叠层结构及半导体器件的形成方法	CN202110460771.9	2021/4/27	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
208	一种磁存储器及其制备方法	CN202110406826.8	2021/4/15	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
209	相变存储器	CN202110729313.0	2021/6/29	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
210	相变存储器及其控制方法和制作方法	CN202110762515.5	2021/7/6	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
211	相变存储器及其制作方法、定位方法和掩模版	CN202110849635.9	2021/7/27	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
212	一种半导体结构及其制造方法	CN202110620581.9	2021/6/3	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
213	存储器系统及其制作方法	CN202111233979.3	2021/10/22	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
214	相变存储系统及其制造方法	CN202110637570.1	2021/6/8	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
215	存储器、存储器系统及存储器的制造方法	CN202110626284.5	2021/6/4	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
216	薄膜沉积方法及薄膜沉积设备	CN202111007035.4	2021/8/30	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
217	一种三维存储器的制造方法及三维存储器	CN202210160775.X	2022/2/22	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
218	相变存储器及其制备方法	CN202210383007.0	2022/4/12	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
219	化学机械研磨设备	CN202220025838.6	2022/1/6	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
220	相变存储器及其制造方法	CN202210986758.1	2022/8/17	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
221	半导体结构及其制造方法、存储器	CN202210195512.2	2022/3/1	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
222	相变存储器及其制作方法	CN202210106648.1	2022/1/28	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
223	相变存储器及其控制方法和制作方法	CN202210210580.1	2022/3/4	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司

上海古鳌电子科技股份有限公司拟了解
新存科技（武汉）有限责任公司股东全部权益价值项目估值咨询报告

序号	发明名称	申请号	申请日	法律状态	申请人
224	一种选通器、存储器及其制备方法	CN202111572179.4	2021/12/21	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
225	一种测试系统	CN202123127647.5	2021/12/13	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
226	相变存储器	CN202222315935.1	2022/8/29	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
227	一种存储器及其制备方法	CN202210014991.3	2022/1/7	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
228	一种三维存储器及其形成方法	CN202210106392.4	2022/1/28	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
229	相变存储器及其制备方法	CN202210303251.1	2022/3/24	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
230	延迟锁相环电路、存储器件及时钟同步方法	CN202210146268.0	2022/2/17	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
231	存储系统、存储系统的形成方法及控制方法	CN202210487083.6	2022/5/6	实质审查	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
232	存储器及存储系统	CN202210073679.1	2022/1/21	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
233	半导体器件及形成方法	CN202210317157.1	2022/3/28	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
234	相变存储器及其制作方法	CN202210031725.1	2022/1/12	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
235	一种三维相变存储器的制造方法及三维相变存储器	CN202210288193.X	2022/3/22	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
236	存储器及其制作方法	CN202210530705.9	2022/5/16	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
237	一种相变存储器的操作方法、相变存储器及存储器系统	CN202210778685.7	2022/6/30	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
238	一种相变存储器的操作方法、相变存储器及存储器系统	CN202210672725.X	2022/6/14	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
239	相变存储器	CN202210798628.5	2022/7/6	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
240	一种相变存储器及其制备方法	CN202210638962.4	2022/6/7	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
241	液体循环装置	CN202221119075.8	2022/5/10	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
242	相变存储器及其控制方法和制作方法	CN202210363693.5	2022/4/7	实质审查	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
243	一种相变存储器的操作方法、相变存储器及存储器系统	CN202210562521.0	2022/5/23	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
244	相变存储材料、相变存储器及其制备方法	CN202210590318.4	2022/5/26	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
245	相变材料层结构及其制备方法和相变存储器	CN202210355441.8	2022/4/6	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
246	相变存储器及其制备方法	CN202210590403.0	2022/5/26	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
247	相变材料、相变存储器、及制备方法	CN202210558687.5	2022/5/20	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
248	温度处理电路、温度处理方法及存储器	CN202210966607.X	2022/8/12	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
249	存储器的驱动电路、驱动方法、存储器及存储系统	CN202210686452.4	2022/6/16	授权	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
250	存储器装置及存储器系统	CN202210825956.X	2022/7/13	实质审查	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
251	存储器及其操作方法、存储器系统、电子设备	CN202310035587.9	2023/1/10	实质审查	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
252	存储器装置及其操作方法、存储器系统及其操作方法	CN202211666517.5	2022/12/23	实质审查	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
253	存储器及其制造方法、电子设备	CN202310542074.7	2023/5/11	实质审查	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
254	相变存储器及其操作方法、存储器系统	CN202310682037.6	2023/6/8	实质审查	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
255	相变存储器及其制造方法	CN202311708233.2	2023/12/13	实质审查	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
256	一种半导体结构及其制备方法	CN202310615743.9	2023/5/24	实质审查	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
257	半导体结构及其形成方法和三维存储结构	CN202310850670.1	2023/7/11	实质审查	长江先进存储产业创新中心有限责任公司

上海古鳌电子科技股份有限公司拟了解
新存科技（武汉）有限责任公司股东全部权益价值项目估值咨询报告

序号	发明名称	申请号	申请日	法律状态	申请人
258	相变存储器及其形成方法、芯片	CN202310662121.1	2023/6/5	实质审查	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
259	一种振荡器电路和频率调节方法	CN202310757540.3	2023/6/25	实质审查	长江先进存储产业创新中心有限责任公司
260	Three-dimensional phase-change memory devices	PCT/CN2019/110947	2019/10/14	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江存储科技有限责任公司
261	三维相变存储器件	CN201980002380.3	2019/10/14	授权	长江存储科技有限责任公司
262	3次元相変化メモリデバイス	JP2021570484	2019/10/14	授权	长江存储科技有限责任公司
263	3 차원 상변화 메모리 디바이스들	KR1020217038359	2019/10/14	授权 复审	长江存储科技有限责任公司
264	三维相變記憶體元件	TW108147260	2019/12/23	授权	长江存储科技有限责任公司
265	Spacial arrangements of and critical dimensions for bit line contacts of three-dimensional phase-change memory devices	US16/727852	2019/12/26	授权	长江存储科技有限责任公司
266	Methods for forming three-dimensional phase-change memory devices	PCT/CN2019/110948	2019/10/14	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江存储科技有限责任公司
267	用于形成三维相变存储器件的方法	CN201980002404.5	2019/10/14	授权	长江存储科技有限责任公司
268	3次元相変化メモリデバイスを形成するための方法	JP2021571426	2019/10/14	授权	长江存储科技有限责任公司
269	3 차원 상변화 메모리 디바이스들을 형성하는 방법들	KR1020217038336	2019/10/14	授权	长江存储科技有限责任公司
270	用於形成三維記憶裝置的方法	TW108147288	2019/12/24	授权	长江存储科技有限责任公司
271	Methods for forming three-dimensional phase-change memory devices	US16/727853	2019/12/26	授权	长江存储科技有限责任公司
272	Phase-change memory	PCT/CN2020/072353	2020/1/16	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江存储科技有限责任公司
273	相变存储器	CN202080000139.X	2020/1/16	授权	长江存储科技有限责任公司
274	相變記憶體	TW109110784	2020/3/30	授权	长江存储科技有限责任公司
275	Phase-change memory	US16/849236	2020/4/15	授权 期限延 长	长江存储科技有限责任公司
276	相变存储器及其制造方法	CN202010861713.2	2020/8/25	实质审查	长江存储科技有限责任公司
277	相变存储器、存储器控制方法及存储芯片	CN202010969755.8	2020/9/15	实质审查	长江存储科技有限责任公司
278	开关器件及其制造方法，相变随机存储器	CN202010974563.6	2020/9/16	授权	长江存储科技有限责任公司
279	Phase-change memory devices, systems, and methods of operating thereof	PCT/CN2021/103403	2021/6/30	PCT 进入指定国 (指定期满)	长江存储科技有限责任公司
280	相变存储器装置、系统及其操作方法	CN202180002652.7	2021/6/30	授权	长江存储科技有限责任公司
281	Phase-change memory devices, systems, and methods of operating thereof	US17/384143	2021/7/23	授权 期限延 长	长江存储科技有限责任公司
282	一种相变存储器	CN202122039311.7	2021/8/26	授权	长江存储科技有限责任公司
283	相变存储器以及相变存储器的制作方法	CN202210469040.5	2022/4/29	实质审查	长江存储科技有限责任公司

b)集成布图

名称	登记号	申请日	权利人
带隙基准电路	235522678	2023/4/1	长江先进存储产业创新中心 有限责任公司
译码器电路	21557382X	2021/6/23	长江先进存储产业创新中心 有限责任公司
存储器件的驱动电路	215573862	2021/6/23	长江先进存储产业创新中心 有限责任公司
存储器的驱动电路	215573919	2021/6/23	长江先进存储产业创新中心 有限责任公司

上海古鳌电子科技股份有限公司拟了解
新存科技（武汉）有限责任公司股东全部权益价值项目估值咨询报告

名称	登记号	申请日	权利人
串并转换器电路	215573935	2021/6/23	长江先进存储产业创新中心 有限责任公司
读操作电压调节器电路	215573943	2021/6/23	长江先进存储产业创新中心 有限责任公司
输出信号驱动电路	215573978	2021/6/23	长江先进存储产业创新中心 有限责任公司
振荡器电路	215573994	2021/6/23	长江先进存储产业创新中心 有限责任公司
输出阻抗校准模拟电路	215652207	2021/11/9	长江先进存储产业创新中心 有限责任公司
基准电压电路	215652215	2021/11/9	长江先进存储产业创新中心 有限责任公司
读写对比检查电路	215652223	2021/11/9	长江先进存储产业创新中心 有限责任公司
数据读写电路	215652231	2021/11/9	长江先进存储产业创新中心 有限责任公司

(2) 自有部分-专利

估值咨询基准日，新存公司提供的专利清单显示共有 164 项专利，其中办登 10 项、公开 3 项、实审 120 项、授权 31 项。明细如下：

序号	申请号	申请日	公开号	公开/授权日	状态	标题	申请人
1	2023116296457	2023/11/29	CN117596898B	2024/5/31	授权	相变存储器及其形成方法、漏电测试方法	新存科技（武汉）有 限责任公司
2	202410292132X	2024/3/14	CN118230788B	2024/12/6	授权	半导体器件及其控制方法	新存科技（武汉）有 限责任公司
3	2024205876069	2024/3/25	CN222148126U	2024/12/10	授权	半导体器件、存储系统 及电子设备	新存科技（武汉）有 限责任公司
4	2024105098279	2024/4/26	CN118430615B	2025/12/9	授权	一种存储系统及其 操作方法	新存科技（武汉）有 限责任公司
5	202410809681X	2024/6/21	CN118609621A	2024/9/6	办登	存储器装置及存储 器系统	新存科技（武汉）有 限责任公司
6	2024209453133	2024/4/30	CN222192952U	2024/12/17	授权	相变存储器	新存科技（武汉）有 限责任公司
7	2024219036305	2024/8/6	CN222939659U	2025/6/3	授权	原位选通存储器	新存科技（武汉）有 限责任公司
8	2024214111846	2024/6/19	CN222762949U	2025/4/15	授权	固定膜组件以及缓 冲膜	新存科技（武汉）有 限责任公司
9	2024108409481	2024/6/27	CN118380412B	2024/9/24	授权	半导体存储器件及 其制造方法	新存科技（武汉）有 限责任公司
10	2024215747384	2024/7/5	CN223038955U	2024/6/27	授权	一种具有对准标记 的半导体结构	新存科技（武汉）有 限责任公司
11	202411031335X	2024/7/30	CN118567575B	2024/12/20	授权	命令地址信号的训 练方法及存储器	新存科技（武汉）有 限责任公司
12	2025105979990	2025/5/9	CN120492246A	2025/8/15	办登	芯片测试方法和电 子设备	新存科技（武汉）有 限责任公司
13	2024108322026	2024/6/26	CN118380031B	2024/9/24	授权	存储器及其操作方 法	新存科技（武汉）有 限责任公司
14	2024112561960	2024/9/9	CN118782119B	2025/2/11	授权	存储器及其操作方 法和存储系统	新存科技（武汉）有 限责任公司
15	2024112009547	2024/8/29	CN118714854B	2024/12/6	授权	存储器及其制备方 法	新存科技（武汉）有 限责任公司
16	2024111077284	2024/8/13	CN119252311A	2025/1/3	办登	半导体器件和半导 体系统	新存科技（武汉）有 限责任公司
17	2024219154000	2024/8/7	CN223029430U	2025/6/27	授权	研磨垫修整盘更换	新存科技（武汉）有

上海古鳌电子科技股份有限公司拟了解
新存科技（武汉）有限责任公司股东全部权益价值项目估值咨询报告

序号	申请号	申请日	公开号	公开/授权日	状态	标题	申请人
						装置及研磨垫修整盘更换系统	有限责任公司
18	2024219794204	2024/8/14	CN223029270U	2025/6/27	授权	研磨装置	新存科技（武汉）有限责任公司
19	2024110851225	2024/8/8	CN119252295A	2025/1/3	办登	数据读取方法、仅选择器存储器及存储器系统	新存科技（武汉）有限责任公司
20	2024112786983	2024/9/12	CN119383984B	2025/10/28	授权	相变存储器及其形成方法	新存科技（武汉）有限责任公司
21	2024114947759	2024/10/24	CN119360921B	2025/9/5	授权	存储器装置及其操作方法	新存微科技（北京）有限责任公司,新存科技（武汉）有限责任公司
22	2024114865602	2024/10/23	CN119479731A	2025/2/18	办登	存储器及其操作方法	新存微科技（北京）有限责任公司,新存科技（武汉）有限责任公司
23	2024113101714	2024/9/19	CN119274608A	2025/1/7	办登	存储器件	新存微科技（北京）有限责任公司,新存科技（武汉）有限责任公司
24	2024112113837	2024/8/30	CN119088310B	2025/11/7	授权	存储器及存储系统	新存微科技（北京）有限责任公司,新存科技（武汉）有限责任公司
25	2024114750702	2024/10/22	CN119495340B	2025/12/26	授权	相变存储器及操作方法	新存科技（武汉）有限责任公司
26	2024113294064	2024/9/24	CN119360920B	2025/11/7	授权	存储器的操作方法以及存储器和存储系统	新存科技（武汉）有限责任公司
27	2024115225849	2024/10/29	CN119403132B	2025/10/3	授权	相变存储器及其制造方法	新存科技（武汉）有限责任公司
28	2024116222975	2024/11/14	CN119724314B	2025/11/7	授权	存储器的监控方法及存储器	新存科技（武汉）有限责任公司
29	202411869509X	2024/12/18	CN119889407B	2025/11/7	授权	存储阵列的修复方法及存储器	新存科技（武汉）有限责任公司
30	2024114862873	2024/10/23	CN119479730B	2025/9/30	授权	存储器	新存微科技（北京）有限责任公司,新存科技（武汉）有限责任公司
31	2024116474887	2024/11/18	CN119479736B	2025/9/9	授权	存储器及其操作方法	新存科技（武汉）有限责任公司
32	2024116342125	2024/11/15	CN119724287A	2025/3/28	办登	存储器	新存科技（武汉）有限责任公司
33	2025105637724	2024/4/30	CN120496603A	2025/8/15	办登	存储系统的操作方法以及存储系统	新存微科技（北京）有限责任公司,新存科技（武汉）有限责任公司
34	2024119158576	2024/12/24	CN119889388B	2025/11/7	授权	补偿电路及存储器	新存科技（武汉）有限责任公司
35	202411937507X	2024/12/26	CN119889385B	2025/10/24	授权	存储单元及其操作方法	新存科技（武汉）有限责任公司
36	2024230228069	2024/12/6	CN223528443U	2025/11/7	授权	相变存储器	新存科技（武汉）有限责任公司
37	202510010198X	2025/1/3	CN119864064A	2025/4/22	办登	一种相变存储器阵列的保持电流确定方法、装置及介质	新存科技（武汉）有限责任公司
38	2025101375385	2025/2/7	CN120108462B	2025/12/26	授权	电压确定电路及存储器	新存科技（武汉）有限责任公司
39	2025100923325	2025/1/21	CN120015086B	2025/11/7	授权	相变存储器及电子设备	新存微科技（北京）有限责任公司,新存科技（武汉）有限责任公司
40	2025101409983	2025/2/8	CN120126527B	2025/11/7	授权	存储器及电子设备	新存微科技（北京）有限责任公司,新存科技（武汉）有限责任公司
41	2025105980004	2025/5/9	CN120496614A	2025/8/15	办登	相变存储器的自适应控制方法、相变存储器、介质及电子设备	新存科技（武汉）有限责任公司

上海古鳌电子科技股份有限公司拟了解
新存科技（武汉）有限责任公司股东全部权益价值项目估值咨询报告

序号	申请号	申请日	公开号	公开/授权日	状态	标题	申请人
75	202410923775X	2024/7/10	CN118918939A	2024/11/8	实审	存储器的测试系统和测试方法	新存科技（武汉）有限责任公司
76	2024108476819	2024/6/27	CN118785723A	2024/10/15	实审	半导体器件及其制造方法	新存科技（武汉）有限责任公司
77	2024112008968	2024/8/29	CN118692535A	2024/9/24	实审	相变存储器及操作方法	新存科技（武汉）有限责任公司
78	202411193977X	2024/8/28	CN119252303A	2025/1/3	实审	一种相变存储器的操作方法、控制电路和相变存储器	新存科技（武汉）有限责任公司
79	2024112306100	2024/9/4	CN119376615A	2025/1/28	实审	存储器的操作方法及存储器	新存科技（武汉）有限责任公司
80	2024112714951	2024/9/11	CN119317117A	2025/1/14	实审	存储器及其制备方法	新存科技（武汉）有限责任公司
81	2024110881235	2024/8/9	CN118995053A	2024/11/22	实审	用于抛光有机介质层的抛光组合物及半导体器件的制造方法	新存科技（武汉）有限责任公司
82	2024110126279	2024/7/26	CN118737814A	2024/10/1	实审	相变存储器的形成方法	新存科技（武汉）有限责任公司
83	2024112367049	2024/9/4	CN120089172A	2025/6/3	实审	存储器	新存微科技（北京）有限责任公司、新存科技（武汉）有限责任公司
84	2024112111244	2024/8/30	CN119207516A	2024/12/27	实审	一种相变存储器及存储器系统	新存科技（武汉）有限责任公司
85	2024115172076	2024/10/29	CN119451558A	2025/2/14	实审	选通器件材料及存储器	新存科技（武汉）有限责任公司
86	2024112864412	2024/9/13	CN119317349A	2025/1/14	实审	选通器件材料及存储器	新存科技（武汉）有限责任公司
87	2024117158923	2024/11/27	CN119562527A	2025/3/4	实审	一种半导体结构	新存科技（武汉）有限责任公司
88	2024110844005	2024/8/8	CN119008597A	2024/11/22	实审	对准标记结构及半导体结构	新存科技（武汉）有限责任公司
89	2024114164922	2024/10/11	CN119443163A	2025/2/14	实审	数据处理装置及其操作方法、电子设备	新存科技（武汉）有限责任公司
90	202411312114X	2024/9/20	CN119325334A	2025/1/17	实审	一种选通材料、半导体器件和存储器	新存科技（武汉）有限责任公司
91	2024114145387	2024/10/11	CN119451553A	2025/2/14	实审	一种半导体器件、存储器和存储系统	新存科技（武汉）有限责任公司
92	2024112767499	2024/9/12	CN120018517A	2025/5/16	实审	相变存储器及其形成方法	新存科技（武汉）有限责任公司
93	2024112294298	2024/9/3	CN119987647A	2025/5/13	实审	存储器和存储器系统	新存微科技（北京）有限责任公司、新存科技（武汉）有限责任公司
94	2024115651530	2024/11/5	CN119724272A	2025/3/28	实审	存储控制结构、控制调节方法及存储器	新存微科技（北京）有限责任公司、新存科技（武汉）有限责任公司
95	2024113747670	2024/9/29	CN119377141A	2025/1/28	实审	存储器的操作方法以及存储器	新存微科技（北京）有限责任公司、新存科技（武汉）有限责任公司
96	2024112414317	2024/9/5	CN119255616A	2025/1/3	实审	半导体结构的制造方法和半导体结构	新存科技（武汉）有限责任公司
97	2024112105188	2024/8/30	CN119207525A	2024/12/27	实审	相变存储器的测试结构及测试方法	新存科技（武汉）有限责任公司
98	2024115323004	2024/10/30	CN119451554A	2025/2/14	实审	半导体结构的制造方法	新存科技（武汉）有限责任公司
99	2024114612083	2024/10/18	CN119476383A	2025/2/18	实审	半导体器件以及半导体器件的制备方法	新存科技（武汉）有限责任公司
100	2024115020834	2024/10/25	CN119364773A	2025/1/24	实审	存储器及其制造方法、存储器系统	新存科技（武汉）有限责任公司
101	2024114643791	2024/10/21	CN119277226A	2025/1/7	实审	测试电路、测试系统及存储系统	新存科技（武汉）有限责任公司
102	2024114643819	2024/10/21	CN119277227A	2025/1/7	实审	测试电路、测试系统及存储系统	新存科技（武汉）有限责任公司
103	2024114579954	2024/10/18	CN119376630A	2025/1/28	实审	地址处理结构及存储器	新存微科技（北京）有限责任公司、新存科技（武汉）有限责

上海古鳌电子科技股份有限公司拟了解
新存科技（武汉）有限责任公司股东全部权益价值项目估值咨询报告

序号	申请号	申请日	公开号	公开/授权日	状态	标题	申请人
							任公司
104	2024114612045	2024/10/18	CN119483582A	2025/2/18	实审	电平转换电路、存储器及电子设备	新存微科技（北京）有限责任公司,新存科技（武汉）有限责任公司
105	2024114664374	2024/10/21	CN119519674A	2025/2/25	实审	比较电路、阻值校准系统及存储器	新存微科技（北京）有限责任公司,新存科技（武汉）有限责任公司
106	2024117624576	2024/12/3	CN119786502A	2025/4/8	实审	半导体结构及其检测方法	新存科技（武汉）有限责任公司
107	2024117172742	2024/11/27	CN119542276A	2025/2/28	实审	一种存储器	新存科技（武汉）有限责任公司
108	202411760244X	2024/12/3	CN119833515A	2025/4/15	实审	半导体结构及其检测方法	新存科技（武汉）有限责任公司
109	2024119044185	2024/12/23	CN119851716A	2025/4/18	实审	半导体器件	新存科技（武汉）有限责任公司
110	202411860626X	2024/12/17	CN119892068A	2025/4/25	实审	信号产生电路及存储器	新存微科技（北京）有限责任公司,新存科技（武汉）有限责任公司
111	2025105637777	2024/4/30	CN120496604A	2025/8/15	实审	存储系统的操作方法以及存储系统	新存微科技（北京）有限责任公司,新存科技（武汉）有限责任公司
112	202411879128X	2024/12/19	CN119889390A	2025/4/25	实审	存储器及存储系统	新存科技（武汉）有限责任公司
113	2024119158650	2024/12/24	CN119789777A	2025/4/8	实审	相变存储器	新存科技（武汉）有限责任公司
114	2024119093213	2024/12/24	CN119789439A	2025/4/8	实审	半导体器件及其形成方法	新存科技（武汉）有限责任公司
115	202411977728X	2024/12/30	CN119883959A	2025/4/25	实审	内存管理方法、装置及存储设备	新存微科技（北京）有限责任公司,新存科技（武汉）有限责任公司
116	2025107648812	2025/6/9	CN120640695A	2025/9/12	实审	一种存储材料、SOM 存储器及其制造方法	新存科技（武汉）有限责任公司
117	2024119044217	2024/12/23	CN119768044A	2025/4/4	实审	半导体器件及其形成方法	新存科技（武汉）有限责任公司
118	2024119651262	2024/12/30	CN119789440A	2025/4/8	实审	半导体器件的形成方法	新存科技（武汉）有限责任公司
119	2025103332115	2025/3/20	CN120149180A	2025/6/13	实审	半导体器件及其形成方法	新存科技（武汉）有限责任公司
120	2025102439473	2025/3/3	CN120076341A	2025/5/30	实审	仅选择存储器	新存科技（武汉）有限责任公司
121	2025101580604	2025/2/13	CN120126538A	2025/6/10	实审	存储健康测试方法及存储器	新存科技（武汉）有限责任公司
122	2025101497043	2025/2/11	CN120105999A	2025/6/6	实审	版图检测方法及电子设备	新存科技（武汉）有限责任公司
123	2025103433703	2025/3/21	CN120279963A	2025/7/8	实审	一种保持电流确定方法及相关装置	新存科技（武汉）有限责任公司
124	2025101929314	2025/2/21	CN120126528A	2025/6/10	实审	存储系统的操作方法以及存储系统	新存科技（武汉）有限责任公司
125	2025103332134	2025/3/20	CN120260644A	2025/7/4	实审	存储系统的操作方法以及存储系统	新存科技（武汉）有限责任公司
126	2025105365734	2025/4/27	CN120496602A	2025/8/15	实审	存储器件的读取方法、装置以及存储器	新存微科技（北京）有限责任公司,新存科技（武汉）有限责任公司
127	2025102205292	2025/2/26	CN120076340A	2025/5/30	实审	一种三维堆叠存储器及其制造方法	新存科技（武汉）有限责任公司
128	2025103608375	2025/3/25	CN120152299A	2025/6/13	实审	一种相变存储器	新存科技（武汉）有限责任公司
129	2025101929329	2025/2/21	CN119855163A	2025/4/18	实审	仅选择存储器	新存科技（武汉）有限责任公司
130	2025102439492	2025/3/3	CN120076341A	2025/5/30	实审	相变存储器	新存科技（武汉）有限责任公司
131	2025106226616	2025/5/14	CN120473386A	2025/8/12	实审	一种等离子体刻蚀的清洗方法及相变存储器	新存科技（武汉）有限责任公司

上海古鳌电子科技股份有限公司拟了解
新存科技（武汉）有限责任公司股东全部权益价值项目估值咨询报告

序号	申请号	申请日	公开号	公开/授权日	状态	标题	申请人
132	2025108146387	2025/6/18	CN120603256A	2025/9/5	实审	相变存储器	新存科技（武汉）有 限责任公司
133	2025103453514	2025/3/24	CN120187035A	2025/6/20	实审	一种存储器及其形 成方法	新存科技（武汉）有 限责任公司
134	2025104140803	2025/4/3	CN120500040A	2025/8/15	实审	仅选择存储器及其 形成方法	新存科技（武汉）有 限责任公司
135	2025103576872	2025/3/25	CN120220777A	2025/6/27	实审	一种相变存储器阵 列的仿真验证方法 及系统	新存微科技（北京） 有限责任公司,新存 科技（武汉）有限责 任公司
136	202510738089X	2025/6/4	CN120748467A	2025/10/3	实审	存储阵列的验证方 法、装置、存储器以 及介质	新存微科技（北京） 有限责任公司,新存 科技（武汉）有限责 任公司
137	2025105976973	2025/5/9	CN120547879A	2025/8/26	实审	半导体器件及其制 造方法	新存科技（武汉）有 限责任公司
138	2025107471460	2025/6/5	CN120640693A	2025/9/12	实审	半导体结构及其制 造方法	新存科技（武汉）有 限责任公司
139	2025107710264	2025/6/10	CN120748460A	2025/10/3	实审	仅选择器存储器、存 储器系统	新存科技（武汉）有 限责任公司
140	2025107610800	2025/6/9	CN120614834A	2025/9/9	实审	一种相变存储器	新存科技（武汉）有 限责任公司
141	2025107613122	2025/6/9	CN120640694A	2025/9/12	实审	一种 SOM 存储器 件及其制造方法	新存科技（武汉）有 限责任公司
142	2025106138278	2025/5/13	CN120456562A	2025/8/8	实审	一种存储结构及其 制造方法	新存科技（武汉）有 限责任公司
143	2025107394820	2025/6/4	CN120600724A	2025/9/5	实审	存储器件及其制备 方法	新存微科技（北京） 有限责任公司,新存 科技（武汉）有限责 任公司
144	2025106516816	2025/5/20	CN120600073A	2025/9/5	实审	一种相变存储器的 控制方法和相变存 储器	新存科技（武汉）有 限责任公司
145	2025106304742	2025/5/16	CN120610138A	2025/9/9	实审	半导体器件的测试 方法、测试装置、电 子设备和介质	新存科技（武汉）有 限责任公司
146	2025106867672	2025/5/27	CN120545181A	2025/8/26	实审	一种存储器的形成 方法和研磨设备	新存科技（武汉）有 限责任公司
147	2025106304776	2025/5/16	CN120513021A	2025/8/19	实审	相变存储器的形成 方法和相变存储器	新存科技（武汉）有 限责任公司
148	2025106651076	2025/5/22	CN120547880A	2025/8/26	实审	相变存储器	新存科技（武汉）有 限责任公司
149	2025110126555	2025/7/22	CN121011218A	2025/11/25	实审	一种存储器的操作 方法、存储器及介质	新存科技（武汉）有 限责任公司
150	2025109466429	2025/7/9	CN121054070A	2025/12/2	实审	三维仅选择存储器 及数据操作方法、电 子设备和存储介质	新存科技（武汉）有 限责任公司
151	2025108958229	2025/6/30	CN120456563A	2025/8/8	实审	存储器和存储系统	新存科技（武汉）有 限责任公司
152	2025110158202	2025/7/23	CN121038291A	2025/11/28	实审	一种存储器的形成 方法以及存储器	新存科技（武汉）有 限责任公司
153	2025109602688	2025/7/11	CN121038288A	2025/11/28	实审	半导体器件的形成 方法和半导体器件	新存科技（武汉）有 限责任公司
154	2025109465125	2025/7/9	CN121038290A	2025/11/28	实审	一种存储器的形成 方法和存储器	新存科技（武汉）有 限责任公司
155	2025110229763	2025/7/24	CN121038292A	2025/11/28	实审	存储器及其制备方 法	新存科技（武汉）有 限责任公司
156	2025109829579	2025/7/16	CN120734902A	2025/10/3	实审	一种研磨装置及其 控制方法	新存科技（武汉）有 限责任公司
157	2025109466359	2025/7/9	CN121054073A	2025/12/2	实审	存储器的读刷新能 力的测试方法以及 存储器、电子设备、 计算机存储介质	新存科技（武汉）有 限责任公司
158	2025112304078	2025/8/29	CN121194471A	2025/12/23	实审	半导体器件的形成 方法和半导体器件	新存科技（武汉）有 限责任公司
159	2025111522018	2025/8/18	CN121152219A	2025/12/16	实审	半导体器件的形成 方法和半导体器件	新存科技（武汉）有 限责任公司
160	2025111685354	2025/8/20	CN121237160A	2025/12/30	实审	一种仅选择器存储 器的操作方法和仅 选择器存储器	新存科技（武汉）有 限责任公司

上海古鳌电子科技股份有限公司拟了解
新存科技（武汉）有限责任公司股东全部权益价值项目估值咨询报告

序号	申请号	申请日	公开号	公开/授权日	状态	标题	申请人
161	2025111402976	2025/8/14	CN121168397A	2025/12/19	实审	集成电路版图验证方法及其装置	新存科技（武汉）有限责任公司
162	2025110357206	2025/7/25	CN121075378A	2025/12/5	实审	一种存储芯片的地址映射方法和存储芯片	新存微科技（北京）有限责任公司, 新存科技（武汉）有限责任公司
163	2025111812203	2025/8/22	CN121194470A	2025/12/23	实审	半导体器件的形成方法和半导体器件	新存科技（武汉）有限责任公司
164	2025113069516	2025/9/12	CN121145772A	2025/12/16	实审	版图电源分析方法、装置以及存储介质	新存科技（武汉）有限责任公司

（3）自有部分-集成布图

名称	登记号	申请日
一种相变存储器中的 16Mb 存储模块的 ARRAY 版图结构	235612987	2023/12/27
一种相变存储器中的 16Mb 存储模块的 CMOS 版图结构	235612995	2023/12/27
一种电编程熔丝的版图结构	235605816	2023/12/11
一种电源产生模块的版图结构	235605824	2023/12/11
一种计数器的版图结构	235605840	2023/12/11
一种内容可寻址存储器的版图结构	235612979	2023/12/27
一种相变存储器布图设计	245516794	2024/3/15
一种分压电阻型基准电压产生器的版图结构	255518072	2025/3/25
一种存储器控制模块的版图结构	255555237	2025/7/15
一种时钟延迟模块的版图结构	25556239X	2025/8/5
一种负电压调节器模块的版图结构	255562403	2025/8/5
一种分压电阻的选择区版图结构	255572085	2025/9/4
一种写操作时进行数据串并转换的解码器的版图结构	25558119X	2025/10/10

（七）利用其他机构报告

本估值咨询报告利用了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所出具的带有强调事项段的无保留意见的年度审计报告。

（八）其他需要说明的问题

无。

四、价值类型

根据估值咨询目的、市场条件、估值咨询对象自身条件等因素，同时考虑价值类型与估值咨询假设的相关性等，确定本次估值咨询的价值类型为：市场价值。

五、估值咨询基准日

本项目估值咨询基准日是 2025 年 12 月 31 日。

本次估值咨询基准日的确定是根据估值咨询业务委托协议，由委托方确定。

六、估值咨询依据

在本次估值咨询工作中我们所遵循的国家、地方政府和有关部门的法律法规，以及在估值咨询中参考的文件资料主要有：

（一）法律法规依据

1、《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议于 2023 年 12 月 29 日修订通过)；

2、《中华人民共和国民法典》(2020 年 5 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第 3 次会议通过)；

3、《中华人民共和国证券法》(2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订)；

4、《中华人民共和国企业所得税法》(2017 年 2 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十六次会议《关于修改〈中华人民共和国企业所得税法〉的决定》修正)；

5、《企业会计制度》；

6、其他与估值咨询有关的法律法规。

（二）企业提供的资料

1、企业提供的财务报表、审计报告等相关财务资料；

2、企业提供的损益测算表、商业计划书、可行性研究报告等资料；

3、企业提供的产品性能验证情况以产线建设资料；

4、企业提供的知识产权授权许可协议；

5、企业管理层的访谈记录。

（三） 估值咨询机构收集的资料

- 1、同花顺资讯；
- 2、估值咨询人员自行搜集的与估值咨询相关资料；
- 3、与本次估值咨询相关的其他资料。

七、 估值咨询方法

（一） 基本介绍

估值咨询专业人员应当根据估值咨询目的、估值咨询对象、价值类型、资料收集等情况，分析市场法、收益法和成本法三种基本方法的适用性，依法选择估值咨询方法。

市场法适用的前提条件是：

- （1）估值咨询对象的可比参照物具有公开的市场，以及活跃的交易；
- （2）有关交易的必要信息可以获得。

收益法适用的前提条件是：

- （1）估值咨询对象的未来收益可以合理预期并用货币计量；
- （2）预期收益所对应的风险能够度量；
- （3）收益期限能够确定或者合理预期。

成本法（资产基础法）适用的前提条件是：

- （1）估值咨询对象能正常使用或者在用；
- （2）估值咨询对象能够通过重置途径获得；
- （3）估值咨询对象的重置成本以及相关贬值能够合理估算。

本次估值咨询选用的估值咨询方法为：收益法。估值咨询方法选择理由如下：

选取收益法的理由：根据新存公司提供的损益预测及商业计划书资料，未来预期收益可以预测并可以用货币衡量、获得未来预期收益所承担的风险可以衡量，故本项目选用收益法。

未选取市场法的理由：考虑新存公司可比的同行业上市公司不满足数量条件、同时同行业市场交易案例较少、且披露信息不足，故本项目不适用于市场法。

未选取资产基础法的理由：考虑标的企业是一家轻资产研发企业，于估值咨询基准日资产主要为租赁房产、新购入的机器设备、在建工程和办公设备，无法反应其未来价值，因此本项目不适用资产基础法。

（二）具体估值咨询思路

1. 收益法估值咨询操作思路

我们采用现金流量折现法对新存公司估值咨询基准日的主营业务价值进行估算，具体方法选用企业自由现金流折现模型。以新存公司收益期企业自由现金流为基础，采用适当折现率折现后加总计算得出新存公司的主营业务价值。

在得出新存公司主营业务价值的基础上，加上非经营性、溢余资产的价值，减去非经营性、溢余负债的价值，得出新存公司企业整体价值，之后减去付息债务价值得出股东全部权益价值。

在企业自由现金流折现模型中，需要进一步解释的事项如下：

（1）企业自由现金流（FCFF）的计算

FCFF=税后净利润+折旧与摊销+财务费用扣税后-资本性支出-营运资金追加

（2）新存公司主营业务价值的计算

新存公司主营业务价值计算公式如下：

$$P = \sum_{i=1}^n \frac{FCFF_i}{(1+r)^i} + \frac{FCFF_{n+1}}{r \times (1+r)^n}$$

其中：P：估值咨询基准日的企业主营业务价值；

FCFF_i：详细预测期第 i 年企业自由现金流；

FCFF_{n+1}：详细预测期后企业自由现金流；

r：折现率（此处为加权平均资本成本，WACC）；

n：收益期；

i：详细预测期第 i 年。

其中，折现率（加权平均资本成本，WACC）计算公式如下：

$$WACC = K_e \times W_e + K_d \times (1 - T) \times W_d$$

其中： K_e ：权益资本成本；
 K_d ：债务资本成本；
 T ：新存公司适用的所得税率；
 W_e ：权益资本结构比例；
 W_d ：付息债务资本结构比例。

其中，权益资本成本采用资本资产定价模型（CAPM）计算。

计算公式如下：

$$K_e = R_f + MRP \times \beta + R_c$$

其中： R_f ：无风险报酬率；
 MRP ：市场风险溢价；
 β ：权益的系统风险系数；
 R_c ：企业特有风险系数。

（3）非经营性、溢余资产的范围

非经营性、溢余资产的范围包括溢余资产和非经营性资产，非经营性、溢余资产的价值等于溢余资产价值和非经营性资产价值之和。

溢余资产和非经营性资产

新存公司估值咨询基准日的资产划分为两类，一类为经营性资产，第二类为非经营性资产。经营性资产是新存公司经营相关的资产，其进一步划分为有效资产和无效资产，有效资产是企业生产经营正在使用或者未来将使用的资产，无效资产又称为溢余资产，指为经营目的所持有，但在估值咨询基准日未使用或者可以预测的未来不会使用的资产。

溢余资产和非经营性资产定义具体如下：

溢余资产指企业持有目的为经营性需要、但于企业特定时期，与企业收益无直接关系、超过企业经营所需的多余资产。通过对新存公司的资产配置状况与企业收益状况进行分析，并进一步对企业经营状况进行了解，判断新存公司是否存在溢余资产。

非经营性资产指企业持有目的为非经营性所需、与企业生产经营活动无直接

关系的资产。

（4）非经营性、溢余负债的范围

非经营性、溢余负债的范围包括溢余负债、非经营性负债等，相应的非经营性、溢余负债的价值等于溢余负债与非经营性负债的价值之和。

（5）股东全部权益价值计算

股东全部权益价值计算公式为：

股东全部权益价值=企业整体价值-付息债务价值

企业整体价值=企业主营业务价值+非经营性、溢余资产价值-非经营性、溢余负债价值

八、估值咨询程序实施过程和情况

根据法律、法规和估值咨询准则的相关规定，本次估值咨询履行了适当的估值咨询程序。具体实施过程如下：

（一）明确估值咨询业务基本事项

与委托方就债务企业和委托方以外的其他估值咨询报告使用者、估值咨询目的、估值咨询对象与估值咨询范围、价值类型、估值咨询基准日、估值咨询报告使用范围、估值咨询报告提交期限及方式、估值咨询服务费及支付方式、委托方及其他相关当事人与估值咨询机构和估值咨询人员工作配合和协助等重要事项进行商讨，予以明确。

（二）签订估值咨询委托合同

根据估值咨询业务具体情况，对估值咨询机构和估值咨询人员专业胜任能力、独立性和业务风险进行综合分析和评价后，与委托方签订估值咨询委托合同。

（三）编制估值咨询计划

根据估值咨询工作的要求，编制估值咨询工作计划，包括确定估值咨询的具体步骤、时间进度、人员安排，拟定估值咨询技术方案等，报公司相关负责人审核、批准。

（四）进行估值咨询现场调查

1、指导委托方、被估值咨询单位等相关当事方清查资产、准备涉及估值咨询对象和估值咨询范围的详细资料；

2、根据估值咨询对象的具体情形，选择适当的方式，通过询问、获取审计函证、核对、检查等方式进行调查，了解估值咨询对象现状，关注估值咨询对象法律权属；对不宜进行逐项调查的，根据重要程度采用抽样等方式进行调查；

3、对被估值咨询单位收益状况进行调查：估值咨询人员主要通过被估值咨询单位未来经营规划以及与管理层访谈对企业的经营业务进行调查。

（五）收集估值咨询资料

收集直接从市场等渠道独立获取的资料，从委托方、被估值咨询单位等相关当事方获取资料，以及从政府部门、各类专业机构和其他相关部门获取资料。

估值咨询人员对估值咨询活动中使用的资料采取适合的方式进行核查验证，核查验证的方式通常包括观察、询问、书面审查、实地调查、查询、获取审计函证、复核等。

（六）评定估算

1、根据估值咨询对象、价值类型、估值咨询资料收集情况等相关条件，分析、选择估值咨询方法；

2、根据所采用的估值咨询方法，选取相应的公式和参数进行分析、计算和判断，形成初步估值咨询结论；

3、对形成的初步估值咨询结论进行综合分析，形成最终估值咨询结论。

（七）编制和提交估值咨询报告

1、估值咨询人员在评定、估算后，形成初步估值咨询结论，按照法律、行政法规的要求编制初步估值咨询报告；

2、根据估值咨询机构内部质量控制制度，对初步估值咨询报告进行内部审核；

3、在不影响对估值咨询结论进行独立判断的前提下，与委托方或者委托方

许可的相关当事人就估值咨询报告有关内容进行沟通，对沟通情况进行独立分析并决定是否对估值咨询报告进行调整；

4、估值咨询机构及其估值咨询人员完成以上估值咨询程序后，向委托方出具并提交正式估值咨询报告。

九、估值咨询假设

在估值咨询过程中，我们所依据和使用的估值咨询假设是估值咨询报告撰写的基本前提，同时提请估值咨询报告使用人关注估值咨询假设内容，以正确理解和使用估值咨询结论。我们遵循以下估值咨询假设条件，如估值咨询报告日后估值咨询假设发生重要变化，将对估值咨询结论产生重大影响。

（一）基本假设

1. 交易假设

交易假设是假定估值咨询对象和估值咨询范围内资产负债已经处在交易的过程中，估值咨询人员根据交易条件等模拟市场进行估值咨询。交易假设是估值咨询得以进行的一个最基本的前提假设。

2. 公开市场假设

公开市场假设是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

3. 资产持续使用假设

资产持续使用假设是指估值咨询时需根据被估值咨询对象按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用，相应确定估值咨询方法、参数和依据。

4. 企业持续经营的假设

企业持续经营的假设是指被估值咨询单位将保持持续经营，并在经营方式上

与现时保持一致。

（二）特殊假设

1、假设估值咨询基准日后，新存公司及其经营环境所处的政治、经济、社会等宏观环境不发生影响其经营的重大变动；

2、本次估值咨询不考虑估值咨询基准日后被估值咨询单位发生的对外股权投资项目对其价值的影响；

3、除估值咨询基准日政府已经颁布和已经颁布尚未实施的影响新存公司经营的法律、法规外，假设生命周期内与新存公司经营相关的法律、法规不发生重大变化；

4、假设新存公司经营者是负责的，且管理层有能力担当其责任，在未来收益期内新存公司主要管理人员和技术人员基于估值咨询基准日状况，不发生影响其经营变动的重大变更，管理团队稳定发展，管理制度不发生影响其经营的重大变动；

5、假设新存公司未来收益期持续经营，经营范围、方式与未来规划经营策略保持一致；

6、假设新存公司按其商业计划书所述规划如期经营发展，且日后不发生与其商业计划书以及企业管理层提供的盈利预测出现重大差异的产能费用变动情况，亦不出现影响新存公司经营的不可抗拒、不可预见性事件；

7、假设新存公司后续如期根据《技术及知识产权许可协议》附件三购买意向方案重约定的金额及支付节点支付新存公司对技术和知识产权资产购买对价；

8、假设新存公司研发进度及技术性能如商业计划书安排如期实现，且日后不发生与其研发进度及技术性能出现重大差异的变动情况，亦不出现影响新存公司研发的不可抗拒、不可预见性事件；

9、假设新存公司如期实现融资，不存在资金链断裂的情况；

10、假设新存公司存储器生产线在绍兴按时间计划完成选址、投资建设并如期投产，建设完成后新存公司与存储器生产线采用定向合作、利润共享方式进行生产；

- 11、 假设新存公司当期产量可以全部实现当期销售并确认收入；
- 12、 假设新存公司预测年度第二代至第三代产品研发成功，达到预期技术性能并如期实现量产；
- 13、 假设新存公司未来收益期应纳税所得额的金额与利润总额基本一致，不存在重大的永久性差异和时间性差异调整事项；
- 14、 假设新存公司未来收益期经营现金流入、现金流出为均匀发生，不会出现年度某一时点集中确认收入的情形；
- 15、 本次估值咨询采用基准日汇率，假设估值咨询基准日后新存公司经营所涉及的汇率、利率、税赋、政策性征收费用及通货膨胀等因素的变化不对其收益期经营状况产生重大影响；
- 16、 假设新存公司提供的资料真实、完整、可靠，不存在应提供而未提供、估值咨询人员已履行必要估值咨询程序仍无法获知的其他可能影响估值咨询结论的瑕疵事项、或有事项等。

根据估值咨询的要求，我们认定这些假设条件在估值咨询基准日时成立。当估值咨询报告日后估值咨询假设发生较大变化时，我们将不承担由于估值咨询假设改变而推导出不同估值咨询结论的责任。

十、 估值咨询结论

（一） 估值咨询结论

根据估值咨询业务委托合同，在经过实施必要的估值咨询程序，截至估值咨询基准日 2025 年 12 月 31 日，新存科技（武汉）有限责任公司纳入估值咨询范围内的所有者权益账面值为-36,065.21 万元，在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益的估值咨询价值为 181,062.16 万元。

（二） 估值咨询结论有效期

除本报告已披露的特别事项，在估值咨询基准日后、使用有效期以内，当经济行为发生时，如企业发展环境未发生影响其经营状况较大变化的情形，估值咨询结论在使用有效期内有效。

当估值咨询结论依据的市场条件或资产状况发生重大变化时，即使估值咨询基准日至经济行为发生日不到一年，估值咨询报告的结论已经不能反映估值咨询对象经济行为实现日的价值，应按以下原则处理：

（1）当资产数量发生变化或资产使用状况发生重大变化时，应根据原估值咨询方法对估值咨询结论进行相应调整；

（2）当估值咨询结论依据的市场条件发生变化、且对估值咨询结论产生明显影响时，委托方应及时聘请有资格的机构重新确定估值咨询对象价值；

（3）估值咨询基准日后，资产状况、市场条件的变化，委托方在估值咨询对象实际作价时应给予充分考虑，进行相应调整。

十一、特别事项说明

特别事项是指在已确定估值咨询结论的前提下，估值咨询人员揭示在估值咨询过程中已发现可能影响估值咨询结果，但非估值咨询人员执业水平和能力所能评定估算的有关事项。我们特别提示估值咨询报告使用人关注特别事项对本估值咨询报告估值咨询结论的影响。

1、估值咨询结论反映的是估值咨询人员遵守法律、行政法规，在履行必要程序后形成的建立在相关假设和限制条件基础上的专业意见。估值咨询结论是股权市场价值的参考依据，委托方和其他报告使用人应当正确理解并恰当使用估值咨询结论。委托方应当在参考估值咨询结论的基础上，结合应收款项合同的约定和市场状况等因素，进行合理决策。

2、本估值咨询报告是在委托方、被估值咨询单位所提供的资料基础上得出的，其真实性、合法性、完整性由委托方、被估值咨询单位负责。在本次分析项目中，估值咨询人员主要依赖委托方和被估值咨询单位提供的资料，未对报告中涉及的财务和其他信息进行验证。提请报告使用者予以关注。

3、经了解新存公司注册资本1,785.7540 万元人民币，截至估值咨询报告日股东未完成实缴。具体股东认缴情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	股东名称	认缴金额	实缴金额	认缴比例
----	------	------	------	------

1	上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）	443.6383	443.6383	24.8432%
2	武汉市科铭芯企业管理合伙企业（有限合伙）	400.00	400.00	22.3995%
3	安吉高维安芯科技合伙企业（有限合伙）	300.00	300.00	16.7996%
4	刘峻	125.00	50.00	6.9999%
5	鞠韶复	125.00	50.00	6.9999%
6	武汉市科凌芯企业管理合伙企业（有限合伙）	50.00	0.00	2.7999%
7	上海科语宸企业管理合伙企业（有限合伙）	198.7622	0.00	11.1304%
8	嘉兴德宁昊坤股权投资合伙企业（有限合伙）	39.3383	39.3383	2.2029%
9	嘉兴德宁隽永创业投资合伙企业（有限合伙）	13.9510	13.9510	0.7812%
10	嘉兴德宁熠鲲股权投资合伙企业（有限合伙）	12.4226	12.4226	0.6957%
11	上海泰瓴芯信息合伙企业（有限合伙）	10.3522	10.3522	0.5797%
12	武汉鼎典私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	46.5849	46.5849	2.6087%
13	上海泰龙芯信息合伙企业(有限合伙)	20.7045	20.7045	1.1594%
合 计		1785.7540	1386.9918	100%

4、本估值咨询报告是在新存公司按其商业计划书及管理层提供的盈利预测预测所述规划经营发展、IP 授权到期后续转让如期实施、按商业计划书实现其产品后续迭代研发进度及技术性能、顺利融资以保持持续经营能力，不存在资金链断裂的情况，生产线如期筹建并按时投产、产品销售定价不存在较大偏差、产品良率如期实现预期水平的特定假设前提上得出的。提请报告使用者予以关注。

5、被估值咨询单位所使用的知识产权由长江先进存储产业创业中心有限责任公司以独占实施许可方式授权给被估值咨询单位使用，该知识产权由北京中企华资产评估有限公司出具了《长江先进存储产业创业中心有限责任公司拟了解知识产权资产价值资产评估报告》（中企华评报字（2023）第 3457 号）。

6、根据新存公司就此和长江先进存储产业创新中心有限责任公司于 2023 年 7 月 26 日签订的技术及知识产权许可协议，许可年限为 5 年，协议约定许可费按照第一代产品销售收入的 1.5%、第二代产品销售收入的 1%收取，并约定最晚于许可协议结束后由新存公司购买相关无形资产并按照许可协议约定支付转让对价。本次估值咨询根据《技术及知识产权许可协议》附件三购买意向方案重约定的金额及支付节点考虑新存公司对技术和知识产权资产购买事项。

7、根据其《关于公司三维相变存储器项目产业化方案的议案》第五条项目产业化方案 2-2 关于有形资产部分，新存公司及其指定的产业化相关方对研发部

分专用机台保留优先购买权，具体价格购买时另议。本次估值咨询已在研发费用中予以考虑该部分成本分摊事项。

8、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所针对基准日报表出具了中汇汉会审[2026]第 0012 号带有强调事项段的无保留意见审计报告，强调事项段表明存在可能导致对新存科技持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。截至 2025 年 12 月 31 日止，新存科技累计净亏损为 9.25 亿元，归属于母公司所有者权益为-3.61 亿元，流动负债高于资产总额。新存科技自成立以来一直处在研究开发阶段，尚未实现盈利。为保障公司正常运营，维持各项目有序推进和研发效率，新存科技将持续通过股权融资及向银行等金融机构融资等方式筹措运营资金。基于上述资金安排和相关计划，新存科技预计可获得的资金来源足够满足未来至少 12 个月的正常运转及研发项目开展需求，因此本财务报表以持续经营为基础编制。

9、估值咨询结论在估值咨询假设前提条件下成立，并限于此次估值咨询目的的使用。当企业生产经营依赖的经营环境发生重大变化，估值咨询人员将不承担由于前提条件和估值咨询依据出现重大改变而推导出不同估值咨询结果的责任。

鉴于被估值咨询单位新存科技（武汉）有限责任公司产品目前已研发公布了一代商用产品，其一代产品尚未实现量产，其 IP 授权到期后续转让实施、产品后续迭代研发进度及技术性能、生产线筹建投产、产品销售定价及良率等方面存在重大不确定性，本报告仅为了解新存科技（武汉）有限责任公司特定假设前提下的股东全部权益市场价值所需，本估值咨询报告不得用于股权交易、增资扩股、借款融资等任何投资、融资等经济行为。

十二、估值咨询报告使用限制说明

1、估值咨询报告只能用于估值咨询报告载明的估值咨询目的和用途、只能由估值咨询报告载明的估值咨询报告使用人使用。

2、委托方或者其他估值咨询报告使用人未按照法律、行政法规规定和估值咨询报告载明的使用范围使用估值咨询报告的，估值咨询机构及其估值咨询人员不承担责任。

3、除委托方、估值咨询业务委托合同中约定的其他估值咨询报告使用人和法律、行政法规规定的估值咨询报告使用人之外，其他任何机构和个人不能成为估值咨询报告的使用人。

4、估值咨询报告使用人应当正确理解估值咨询结论。估值咨询结论不等同于估值咨询对象可实现价格，估值咨询结论不应当被认为是对估值咨询对象可实现价格的保证。

十三、特别风险提示

1、市场风险

①宏观经济及政策

经济形势方面：存储器是一种应用领域广泛的产品，应用于消费电子、信息通信、智能汽车、数据中心、服务器、其他等行业，在集成电路细分市场中处于重要地位。而集成电路产业是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业。因此存储器行业的发展周期伴随国家整体经济形势的变化而变化。

行业政策方面：从全球范围而言，集成电路行业一直受到各国政府和国际组织的政策监管。当前，集成电路行业是我国重点发展的行业，随着经济全球化和产业结构调整的不断深入，国家对集成电路行业的政策的调整，将带来行业的市场需求和产业竞争状况的变化，从而影响到新存公司的发展。

②市场环境

存储器是半导体的重要市场之一，其约占据了半导体近 1/3 的市场份额。其中，从存储芯片细分产品来看，DRAM 和 NAND Flash 占据了存储芯片 95% 以上的市场份额，NOR 闪存占比 1%，其他存储芯片份额较小。

三维相变存储器未来市场规模存在较大的不确定性，从而影响新存公司未来的业务及经营业绩。

③其他竞争者

截至估值咨询基准日估值咨询人员了解到行业内在三维相变存储器领域已有行业大厂布局，如 SK 海力士半导体（中国）有限公司在 2021 年 2 月已宣布在

相变存储器领域取得进展；国际商用机器公司（IBM）长期从事相变存储技术研究，其研究方向已从二维相变存储器转入三维相变存储器；三星集团已开发出三维相变存储器测试芯片；西部数据公司已组建团队攻关三维相变存储技术等。

未来存在其他竞争者技术上出现重大突破的可能性，从而导致新存公司未来盈利能力受到不利影响。

④ 地缘政治

近年来中美贸易摩擦叠加疫情影响，集成电路存储器产业已成为地缘政治争端的主战场之一，地缘政治风险将在一定程度上引发国际集成电路供应链危机。近年来，美国联合其“盟友”国家通过不断制定、更新、出台《瓦森纳协议》、《美国创新与竞争法案》、《美国芯片法案》等法规文件，以及 UVL 最新禁令，试图建立将中国排除在外的国际集成电路供应链体系；美国更试图拉拢日本、韩国和中国台湾建立“芯片四方联盟”，打压中国大陆存储器产业。

新型存储技术是存储器产业发展的另一赛道，目前尚未对美国形成威胁，美国 BIS 出口管制新规（实体名单禁令）目前尚未涉及到三维相变存储等新型存储技术。

新存公司存在未来地缘政治不确定性导致新型存储产业发展困难的可能性，从而因产能受限影响其业务规模及经营业绩。

2、自身风险

① 技术方面

通过技术研发实现产品理化指标、品质稳定、规模应用等，是存储器行业的关键竞争要素之一。其中小纳米级芯片技术工艺、新材料和新工艺的开发能力、新型芯片架构等方面是行业内厂商技术竞争的关键。

当前新存公司 3DPCM 项目已公布了一代商用产品。未来产品迭代存在研发方向偏差、测试芯片功能验证不通过、技术难度加大等原因而导致研发失败的风险。

② 生产风险

三维相变存储器生产主要涉及 CMOS 代加工、存储阵列、封装测试环节。

其中：存储阵列环节要求专用设备和独特工艺来筹建存储生产线。未来存储生产线项目落地及 CMOS 代加工及封装测试环节签约合作厂商达成量产有较大的不确定性，从而影响新存公司的正常生产经营。

③ 融资风险

新存公司目前处于产品研发阶段，其研发支出、偿还到期债务和量产生产线需要大量资金支持，假设未来需要多轮次融资才能可持续性进行研发和实现量产。如不能按期融资新存公司存在资金链断裂的风险，从而对其正常生产经营产生重大不利影响。

十四、估值咨询报告日

本估值咨询报告日为 2026 年 4 月 10 日。

【估值咨询报告签字盖章页 | 此页无正文】

估值咨询人员签名 1: _____ 沃克森（北京）国际资产评估有限公司

估值咨询人员签名 2: _____ 中国·北京

二〇二六年四月十日